

#6/Priority Paper
DELAKE
7.1.00

- 1 -

Docket: 0756-2092

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re PATENT application of)

Koichiro TANAKA)

Serial No. 09/481,396)

Filed: January 12, 2000)

For: LASER IRRADIATION)

APPARATUS)



Group Art Unit: Unassigned

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT AND CLAIM OF FOREIGN
FILING DATE PURSUANT TO 35 U.S.C. § 119

Assistant Commissioner for Patents

Washington, D.C. 20231

Sir:

At the time of filing the above-referenced application, benefit of foreign priority under 35 U.S.C. § 119 was claimed. Submitted herewith is a certified copy of:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO.</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	11-144064	May 24, 1999

to perfect the claim of priority. Acknowledgment is respectfully requested.

Respectfully submitted,

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as First Class Mail in an envelop addressed to: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D.C. 20231, on 3-31-00

Deleen M. Sasaki

Eric J. Robinson
Reg. No. 38,285
NIXON PEABODY LLP
8180 Greensboro Drive, Suite 800
McLean, Virginia 22102
(703) 790-9110

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年 5月24日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第144064号

出 願 人

Applicant(s):

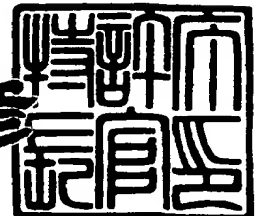
株式会社半導体エネルギー研究所



2000年 1月28日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特2000-3002436

【書類名】 特許願

【整理番号】 P004198-01

【提出日】 平成11年 5月24日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 田中 幸一郎

【特許出願人】

【識別番号】 000153878

【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】 山崎 舜平

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成10年特許願第197884号

【出願日】 平成10年 7月13日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 レーザー照射装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

一方向にレーザービームを分割するレンズと、
前記分割したレーザービームを重ね合わせる光学系とを有し、
前記レンズに入射するレーザービームの形状は前記方向に垂直な境界を有することを特徴とするレーザー照射装置。

【請求項 2】

一方向にレーザービームを分割するレンズと、
前記分割したレーザービームを重ね合わせる光学系とを有し、
前記レンズの前に前記方向に垂直な境界をレーザービームに形成するスリットを設けたことを特徴とするレーザー照射装置。

【請求項 3】

一方向にレーザービームを分割する光学系と、
前記分割したレーザービームを重ね合わせる光学系とを有し、
前記方向において、前記分割する光学系の幅よりもレーザービームの最大幅が広いことを特徴とするレーザー照射装置。

【請求項 4】

一方向にレーザービームを分割するシリンドリカルレンズ群と、
前記分割したレーザービームを重ね合わせる光学系とを有し、
前記シリンドリカルレンズ群のシリンドリカルレンズの一部を遮光していることを特徴とするレーザー照射装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本明細書で開示する発明は、大面積にレーザービームを高い均質性で照射することができる技術に関する。またその応用方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、ガラス等の絶縁基板上に形成された非単結晶半導体膜（単結晶でない、非晶質半導体膜や多結晶、微結晶等の結晶性を有する半導体膜およびこれらの結晶性が混合した半導体膜）に対し、レーザーアニールを施して、結晶化させたり、結晶性を向上させる技術が、広く研究されている。上記半導体膜には、珪素膜がよく用いられる。

【0003】

ガラス基板は、従来よく使用されてきた石英基板と比較し、安価で加工性に富んでおり、大面積基板を容易に作成できる利点を持っている。これが上記研究が行われる理由である。また、結晶化に好んでレーザーが使用されるのは、ガラス基板の融点が低いからである。レーザーは基板の温度をあまり変えずに非単結晶半導体膜にのみ高いエネルギーを与えることができる。

【0004】

レーザーアニールを施して形成された結晶性珪素膜は、高い移動度を有するため、この結晶性珪素膜を用いて薄膜トランジスタ（TFT）を形成し、例えば、一枚のガラス基板上に、画素駆動用と駆動回路用のTFTを作製する、モノリシック型の液晶電気光学装置等に利用されている。該結晶性珪素膜は多くの結晶粒からできているため、多結晶珪素膜、あるいは多結晶半導体膜と呼ばれる。

【0005】

また、出力の大きい、エキシマレーザー等のパルスレーザービームを、被照射面において、一辺が数cm程度の長方形或いは正方形のスポットや、数百 μ m幅 \times 数10cmの線状となるように光学系にて加工し、レーザービームを走査させて（レーザービームの照射位置を被照射面に対し相対的に移動させて）、レーザーアニールを行う方法が、量産性が良く、工業的に優れているため、好んで使用される。

【0006】

特に、線状レーザービームを用いると、前後左右の走査が必要なスポット状のレーザービームを用いた場合とは異なり、線状レーザーの線方向に直角な方向だけの走査で被照射面全体にレーザーアニールを行うことができるため、高い量産

性が得られる。線方向に直角な方向に走査するのは、それが最も効率のよい走査方向であるからである。この高い量産性により、現在レーザーアニールには線状レーザービームを使用することが主流になりつつある。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

線状、長方形或いは正方形に加工されたレーザービームを走査させて、非単結晶半導体膜に対してレーザーアニールを施すに際し、いくつかの問題が生じている。その中でも特に深刻な問題の1つはレーザービームの加工が均一に為されないことであった。そうしたレーザービームを用いると、基板全面に対し不均一なレーザーアニールが行われた。

【0008】

図1は、非晶質珪素膜に対し、従来の光学系を用いて線状に加工したレーザービームを1ショット照射した状態を示す光学顕微鏡写真である。写真中央にレーザービームの照射痕が確認される。

【0009】

図1の場合、波長が308nmのXeClエキシマレーザーを紙面の左右方向に延長する線状のレーザービームとし、これを非晶質珪素膜に1ショット照射した場合である。

【0010】

図1から、線状レーザービームの幅方向の端（エッジ）、特に紙面下側のエッジがギザギザとなっており、不規則なエネルギー分布を持つ線状レーザービームであることが確認される。

【0011】

図2aは、図1に示す不規則なエネルギー分布を持つ線状レーザービーム201を被膜209に照射した状態を模式的に示す図である。

【0012】

図2aに示すように、高いエネルギー密度を有する領域202が幅方向の中心付近に形成され、領域202に比べ低いエネルギー密度を有する領域203が幅方向の周辺部に形成されている。図2aのX-X'とY-Y'におけるエネルギー

一分布の断面形状を図 2 b、c に夫々示す。

【0013】

図 2 a 乃至 c から、線状レーザービーム 201 は、幅方向におけるエネルギー分布の断面形状が異なることが分かる。

【0014】

図 2 a の線状レーザービーム 201 を用いて、被膜をレーザーアニールしても、被膜を均一にレーザーアニールすることはできなかった。

【0015】

本明細書で開示する発明は、レーザービームの一方向におけるエネルギー分布を一様にし、被膜を均一にレーザーアニールすることを課題とする。本明細書中でレーザービームとは、レーザービーム内の最大エネルギーの 5% 以上の領域を指す。

【0016】

〔発明に至る過程〕

一般にレーザービームを線状に加工する場合、元が概略長方形形状のレーザービームを適当な光学系に通して線状に加工する。前記概略長方形形状のレーザービームはアスペクト比が 2 から 5 程度であるが、例えば、図 3 に示した光学系により、アスペクト比 100 以上の線状レーザービームに変形される。その際、エネルギーのビーム内分布も同時に均質化されるように、上記光学系は設計されている。

【0017】

図 3 に示す装置は、ビーム発生装置 301 からのレーザービーム（この時点では概略長方形形状を有している）を 302、303、304、306、308 で示す光学系を介して、線状ビームとして照射する機能を有している。なお、305 はスリット、307 はミラーである。

【0018】

302 は、レーザービームを一方向、ここでは線方向に分割する役割を果たす光学レンズであり、シリンドリカルレンズ群（多シリンドリカルレンズとも称される）を用いている。この分割された多数のビームは、シリンドリカルレンズ 3

06で線方向に関して重ね合わせ均一化する。

【0019】

この構成は、レーザービーム内の強度分布を改善するために必要とされる。また、シリンドリカルレンズ群303も上述したシリンドリカルレンズ群302と同様に、レーザービームを他の方向、ここでは幅方向に分割し、シリンドリカルレンズ304、308によって、幅方向に関して重ね合わせ均一化する。

【0020】

即ち、シリンドリカルレンズ群302とシリンドリカルレンズ306の組み合わせは、線状レーザービームの線方向における強度分布を改善する機能を有し、シリンドリカルレンズ群303とシリンドリカルレンズ304、308の組み合わせは、線状レーザービームの幅方向における強度分布を改善する機能を有している。

【0021】

ここで、幅方向に関して、シリンドリカルレンズを304と308の2枚用いているのは、被照射面309における線状レーザービームの幅方向をより細くするためである。線状レーザービームの幅によっては、重ね合わせるための光学系を1つにすることもあり、また3つ以上とすることもある

【0022】

レーザービーム内のエネルギー分布を均質化する役割を果たす光学系をビームホモジェナイザーと呼ぶ。図3に示した光学系もビームホモジェナイザーの1つである。元の概略長方形のレーザービームをシリンドリカルレンズ群302、303で分割後、各々シリンドリカルレンズ306、304および308で整形し重ね合わせてエネルギー分布を均質化する。

【0023】

理論上は、無限個のシリンドリカルレンズを有するシリンドリカルレンズ群を用いてレーザービームのエネルギー分布を均一化すれば、どのような断面形状のレーザービームが入射しても均一なレーザービームとすることが可能である。

【0024】

しかしながら、産業上利用可能なシリンドリカルレンズ群は、精度やコスト等

の事情により数個、多くても数十個のシリンドリカルレンズを組み合わせている。このようなシリンドリカルレンズ群は、入射するレーザービームの断面形状と入射の状態によって、不規則なエネルギー分布を有するレーザービームに加工される。

【 0 0 2 5 】

従来では、あまり問題とされていなかったこの不均一が、薄膜トランジスタ（TFT）に代表される微小な素子を同一基板上に多数形成する被膜に対するレーザーアニールに用いた場合は、上記した数々の問題を引き起こすことを発明者は見出した。

【 0 0 2 6 】

図 4 a、b は、線状レーザービームに加工するビームホモジェナイザーにおいて、幅方向にレーザービームを分割するシリンドリカルレンズ群 4 0 3 とそこに入射するレーザービーム 4 0 1 の例である。

【 0 0 2 7 】

図 4 a、b に示すように、図 3 のビーム発生装置 3 0 1 から発射され、分割する光学系に入射するレーザービーム 4 0 1、4 0 1' は、概略長方形の断面形状を有している。

【 0 0 2 8 】

ビーム発生装置 3 0 1 から発射されるレーザービームは、完全な長方形で発射されるのが理想であるが、現実的には今の技術では不可能であり、概略長方形の断面形状となる。

【 0 0 2 9 】

図 4 a において、一番上端のシリンドリカルレンズ 4 0 3 1 と一番下端のシリンドリカルレンズ 4 0 3 6 では、レーザービームがシリンドリカルレンズの全幅に入射していない。しかも、入射するビーム形状は不規則である。

【 0 0 3 0 】

一方、その間の 4 つのシリンドリカルレンズ 4 0 3 2 ~ 5 では、各々のレンズの全幅にレーザービームが入射している。

【 0 0 3 1 】

図 5 は、線状レーザービームを加工する光学系から、幅方向に関して加工する光学系の一部を抜き出した構成を示す図である。図 5 に示すように、シリンドリカルレンズ群 5 0 3 に対してレーザービーム 5 0 1 が図 4 a で示すように入射すると、シリンドリカルレンズ 5 0 3 1 および 5 0 3 6 に、レーザービームの境界が直線ではなく、不規則な形状でレーザービームが入射する。

【0 0 3 2】

そのため、シリンドリカルレンズ 5 0 3 1 および 5 0 3 6 によって分割されたレーザービームは、レーザービームの不規則な形状を保持したままシリンドリカルレンズ 5 0 4 により被照射面 5 0 9 に重ね合わされる。よって、線方向において一様ではない、つまり幅方向におけるエネルギー分布の断面形状が線方向によって異なる線状レーザービームが形成される。

【0 0 3 3】

そして、例えば、図 2 a に示すような高いエネルギー密度を有する領域 2 0 2 が幅方向の中心付近に形成され、領域 2 0 2 に比べ低いエネルギー密度を有する領域 2 0 3 が幅方向の周辺部に形成された線状レーザービームとなる。

【0 0 3 4】

また、図 4 b に示すようにレーザービーム 4 0 1 ' が幅方向に分割するシリンドリカルレンズ群 4 0 3 ' に入射すると、シリンドリカルレンズ 4 0 3 5 ' に不規則な形状のレーザービームが入射するため、同様に線状レーザービームの線方向において一様ではなくなる。

【0 0 3 5】

以上から発明者は、以下のことを見出した。レーザービームによる不均一なレーザーアニールの原因は、レーザービームを分割するシリンドリカルレンズ群の一部のシリンドリカルレンズに対して不規則な形状のレーザービームが入射することにある。これにより、線状レーザービームのエネルギー分布が不規則なものとなる。

【0 0 3 6】

【課題を解決するための手段】

本発明の一つは、レーザー照射装置において、一方向にレーザービームを分割

するレンズと、前記分割したレーザービームを重ね合わせる光学系とを有し、前記レンズに入射するレーザービームの形状は前記方向に垂直な境界を有することを特徴とする。

【0037】

また、本発明の他の一つは、レーザー照射装置において、一方向にレーザービームを分割するレンズと、前記分割したレーザービームを重ね合わせる光学系とを有し、前記レンズの前に前記方向に垂直な境界をレーザービームに形成するスリットを設けたことを特徴とする。

【0038】

また、本発明の他の一つは、レーザー照射装置において、一方向にレーザービームを分割するシリンдриカルレンズ群と、前記分割したレーザービームを重ね合わせる光学系とを有し、前記方向において、前記シリンдриカルレンズ群の幅よりもレーザービームの最大幅が広いことを特徴とする。

【0039】

また、本発明の他の一つは、レーザー照射装置において、一方向にレーザービームを分割するシリンдриカルレンズ群と、前記分割したレーザービームを重ね合わせる光学系とを有し、前記シリンдриカルレンズ群のシリンдриカルレンズの一部を遮光していることを特徴とする。

【0040】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の形態の一つを図6を用いて説明する。図6は、簡便のため、線状レーザービームを加工する装置の幅方向に関するホモジェナイザーのみを示している。

【0041】

また、以下の説明では、発射時の断面形状が概略長方形形状のレーザービームを例示しているが、本発明の特徴は加工されるレーザービームの断面形状であり、発射時にどのような断面形状を有していても用いることができる。但し、レーザービームのエネルギーを効率的に用いるためには、円状或いは楕円状のレーザービームに比べて長方形形状のレーザービームが好ましい。

【0 0 4 2】

概略長方形のレーザービーム 6 0 1 の周縁部をスリット 6 1 0 を用いて除去し、長方形のレーザービームとする。スリット 6 1 0 によって、レーザービームの境界は不規則な形状から直線に加工される。また、直線がシリンドリカルレンズ群 6 0 3 の分割する方向（幅方向）とは垂直な直線が得られるようにスリット 6 1 0 を配置する。

【0 0 4 3】

そして、この長方形のレーザービームを分割する光学系、ここではシリンドリカルレンズ群 6 0 3 に入射する。スリット 6 1 0 は、ガラス、石英製のすりガラス、セラミック、金属等が使用できるが、特にすりガラスによる遮光が好ましい。
なぜなら、石英はレーザによる変質がなく、半導体製造に有害な物質を発生しにくいからである。

【0 0 4 4】

本発明で利用できるレーザービームは、K r F、X e C l、A r F、K r C l 等のエキシマレーザーに限定されるものではなく、A r レーザー、Y A G レーザー、C O 2 レーザー等の各種レーザービームを用いることができる。

【0 0 4 5】

この際、長方形のレーザービームの分割する方向と垂直な境界、つまり図 6 では長方形の長辺と、シリンドリカルレンズ群のシリンドリカルレンズ同士の境界とを平行にする。また、長方形の短辺と、図示していないが線方向に分割するシリンドリカルレンズ群のシリンドリカルレンズ同士の境界とを平行にする。

【0 0 4 6】

シリンドリカルレンズ群 6 0 3 に入射したレーザービームは、一方向に分割され、シリンドリカルレンズ 6 0 4 により被照射面 6 0 9 に重ね合わされ、高エネルギー密度領域 2 0 2 および低エネルギー密度領域 2 0 3 を形成するが、線方向に一樣なレーザービームが得られる。

【0 0 4 7】

スリットにより境界が直線を有する長方形に加工されたレーザービームが、シ

リンドリカルレンズ群に入射する際に、長方形の長辺と、幅方向に分割するシリンドリカルレンズ群のシリンドリカルレンズ同士の境界あるいはシリンドリカルレンズ群の端辺とが一致し、長方形の短辺と、線方向に分割するシリンドリカルレンズ群のシリンドリカルレンズ同士の境界あるいはシリンドリカルレンズ群の端辺とが一致すると、一致しない場合に比べて加工された線状レーザービームのエネルギー密度の高い領域を広くすることができる。

【0048】

そのため、大面積にレーザービームを加工（線状であれば線方向に長く）することが可能であり、生産性が向上する。なお、本段落でいうエネルギー密度の高い領域とは、レーザーアニールするために必要なエネルギー密度以上の領域を指す。

【0049】

更に、線状レーザービームのエネルギー分布は該ビームの端を除いた領域ではほぼ一様となる。そのため、より均一なレーザーアニールが可能となる。

【0050】

一方、図6に示すようにスリットにより長方形に加工されたレーザービームが、シリンドリカルレンズ群に入射する際に、レーザービームの分割する方向に垂直な境界の少なくとも一方と、シリンドリカルレンズ群のシリンドリカルレンズ同士の境界あるいはシリンドリカルレンズ群の端辺とが一致していないと、複数のエネルギー密度を有する線状レーザービームが得られる。

【0051】

また、他の実施の形態として、分割する光学系の分割する方向における幅よりも、入射するレーザービームの分割する方向における幅を広くすることが挙げられる。

【0052】

図7にその一例を示す。図7において、シリンドリカルレンズ群703は、従来であれば不規則な形状のレーザービームが入射するシリンドリカルレンズ7031、7036を例えば石英製のすりガラスに置換することにより遮光して、分割する光学系（シリンドリカルレンズ7032～7035）の分割する方向にお

ける幅よりもレーザービームの同方向における幅を広くすることにより、入射する概略長形状のレーザービーム 7 0 1 に直線の境界を与えている。

【 0 0 5 3 】

図 7 には、簡便のため、レーザービームの幅方向に関するホモジェナイザーのみを示したが、線方向に関しても同様の構成の分割する光学系を用いることが好ましい。

【 0 0 5 4 】

より簡易な方法として、分割する光学系 7 0 3 自体の分割する方向における幅よりも、入射するレーザービーム 7 0 1 の分割する方向における幅を広くすることでも直線の境界とすることが可能である。

【 0 0 5 5 】

そして、分割されたレーザービームは、シリンドリカルレンズ 7 0 4 により被照射面 7 0 9 に重ね合わされる。このようにして加工されたレーザービームは、分割した方向のエネルギー分布を一様にすることができ、加えてエネルギー密度の高い領域を広くすることができる。

【 0 0 5 6 】

このように、概略長形状のレーザービームの周縁部を除去することにより、長方形のレーザービームを形成するが、レーザービームのエネルギー損失を防ぐため、除去される部分はできるだけ少なくすることが好ましい。

【 0 0 5 7 】

また、できるだけレーザービームの中心付近にあるエネルギー密度の大きい部分が、分割する光学系に入射するように光学系を配置することが好ましい。

【 0 0 5 8 】

また、被照射面で複数のエネルギー密度を有するレーザービームは、分割するシリンドリカルレンズ群への入射の状態を制御することにより、様々な形状をとることができる。例えば、図 9 a に示すように、エネルギー密度が異なる 3 つの領域を有し、真ん中の長形状のエネルギー密度が最も高い凸型の形状、図 9 b に示すように、エネルギー密度が異なる 3 つの領域を有し、真ん中の長方形のエネルギー密度が最も低い凹型の形状、或いは図 9 c に示すように、エネルギー密

度が異なる 2 つの領域を組み合わせた形状のエネルギー分布等である。

【 0 0 5 9 】

図 8 は、本発明を用いたレーザー照射装置の一例である。ビーム発生装置 8 0 1 から照射された概略長方形のレーザービームは、反射ミラー 8 0 2 を介して光学系 8 0 3、8 0 8 により線状に加工される。

【 0 0 6 0 】

反射ミラー 8 0 7 は、レーザービームの向きを被処理基板 8 0 9 の方向へと反射する。反射ミラー 8 0 7 は必ずしも必要ではないが、レーザー照射装置をコンパクトにするため設けた。反射ミラー 8 0 7 を設けない光学系の例は図 2 1 に、反射ミラーの搬入位置を変えた光学系の例は図 2 2 に示した。

【 0 0 6 1 】

そして、被処理基板 8 0 9 を保持した照射ステージ 8 0 5 は、線状レーザービームの幅方向に関して移動することができる。図 8 で示すレーザー照射装置では、照射ステージが移動する構造であるが、線状レーザービームが移動する構造も可能である。

【 0 0 6 2 】

しかしながら、線状レーザービームを移動させるとエネルギー分布が変化しやすくなり、不均一なレーザーアニールとなる虞がある。従って、照射ステージを移動させる方が好ましい。

【 0 0 6 3 】

光学系 8 0 3 は、レーザービームを線方向に加工する光学系と、幅方向に分割する光学系とを含む。また、光学系 8 0 8 は、幅方向に分割されたレーザービームを同一面で重ねあわせる役割を果たす。

【 0 0 6 4 】

反射ミラー 8 0 2 の役割を以下に記す。ビーム発生装置 8 0 1 から射出するレーザービームの方向は、レーザー照射装置のメンテナンスのたびに微妙に変化する。よって、直接レーザービームを光学系 8 0 3 に配設されているレンズに対して垂直で、且つ平行な光線として入射することは難しい。

【 0 0 6 5 】

そのため、反射ミラー 8 0 2 をビーム発生装置の射出口に配置し、反射ミラー 8 0 2 の角度を調節することによりレーザービームの方向を微調節できるようにした。その結果、光学系 8 0 3 にレーザービームをほぼ平行に入射させることができた。

【 0 0 6 6 】

以上に、線状レーザービームに加工するビームホモジェナイザーと、該ビームホモジェナイザーを用いたレーザー照射装置を示した。

【 0 0 6 7 】

更に、上記のビームホモジェナイザーは、線状だけではなくアスペクト比が 1 0 0 以下の長形状または正形状にレーザービームを加工する際にも応用することができる。

【 0 0 6 8 】

このようなレーザー照射装置において、レーザービームを分割する光学系とビーム発生装置の間に図 6 で示すようなスリット 6 1 0 を配設し、概略長形状のレーザービームの周縁部を除去し、境界が直線の長方形のレーザービームとする。

【 0 0 6 9 】

また、スリット 6 1 0 により全ての周縁部を除去し、長方形とする以外に、正方形とすることもできる。また、スリットにより周縁部の一部のみを除去することも可能である。その際に、後述するように、線状レーザービームに加工する場合には、少なくとも幅方向に分割する光学系への不規則な形状のレーザービームの入射は除去する必要がある。

【 0 0 7 0 】

また、分割する光学系に不規則な形状のレーザービームの入射を取り除く手段として、スリット 6 1 0 の代わりに、分割する光学系の分割する方向における幅よりも、入射するレーザービームの分割する方向における幅を広くする方法がある。その一例として、図 7 で示すようにシリンドリカルレンズ群の一部のシリンドリカルレンズを遮光する方法がある。

【 0 0 7 1 】

この方法では、幅方向に分割するシリンドリカルレンズ群と線方向に分割するシリンドリカルレンズ群の両方に適用することが好ましいが、線状レーザービームを形成する場合においては、少なくとも幅方向に分割するシリンドリカルレンズ群に対して適用する必要がある。

【 0 0 7 2 】

線状レーザービームにおいて、少なくとも幅方向に分割する光学系への不規則な形状のレーザービームの入射は除去しなければならない。その理由は、レーザーアニールを行う際に、線状レーザービームは線方向に直交する方向、つまり幅方向へ被照射基板を相対的に移動するため、幅方向のエネルギー分布の違いは、基板全面に対して不均一なレーザーアニールとなる。

【 0 0 7 3 】

一方、線方向に分割する光学系への不規則なビームの入射は線状レーザービームの中央部分のエネルギー分布にはあまり影響しないので、該中央部分のみを使えば、産業上利用することは可能である。

【 0 0 7 4 】

長方形状または正方形状のレーザービームを用いて被照射面を走査する場合において、長方形状または正方形状のレーザービームの一辺の長さ（長方形の場合であれば長辺の長さ）が、基板の短辺の長さよりも長ければ線状レーザービームと同様に一方向に一度走査するだけでレーザーアニールはすむ。

【 0 0 7 5 】

しかし、長方形状または正方形状のレーザービームの長辺方向の長さが、基板の短辺の長さよりも短い場合は、長方形状または正方形状のレーザービームを複数回走査する必要があり、照射ステージの移動機構も複雑になる。

【 0 0 7 6 】

被照射基板は、ガラス基板に限定されるものではなく、石英基板、セラミックス基板、半導体基板、プラスチック基板または有機樹脂基板等を用いることが可能である。特に高温に弱いガラス基板、プラスチック基板あるいは有機樹脂基板にレーザーアニールを用いるのは有効である。

【 0 0 7 7 】

本発明を用いたレーザービームの用途の一例は、非晶質、多結晶或いは微結晶等の結晶構造を有する被膜の結晶化若しくは結晶性の向上である。結晶性の向上とは、ラマン分光分析等により確認される被膜の結晶構造がより単結晶に近づくことであるが、本発明者は、ラマン分光分析の結果とは別にレーザーアニールにより被膜の電界効果移動度が増加することを見出しており、この電界効果移動度の増加も含めて結晶性の向上と称する。

【0078】

さらに、被膜中に添加された不純物の活性化、イオン注入等による被膜の結晶構造の乱れを回復するためのレーザーアニール等に利用することができる。

【0079】

このような、用途を前提とすると、特にシリコンを主成分とする被膜に本発明は効果的であるが、当然ながら、本発明の被照射被膜として特定の膜に限定されるものでない。

【0080】

以下の実施例で示すのは、本発明の一例であり、本発明を実施例に限定するものではない。例えば、分割する光学系に半シリンドリカルレンズ群を用いて、球面収差の影響を緩和し、被照射面におけるエネルギー分布の端部が垂直な断面形状を有するレーザービームを加工する際に利用することも可能である。

【0081】

【実施例】

〔実施例1〕

図10は、非晶質珪素膜に対し、図8のレーザー照射装置を用いて線状に加工したレーザービームを1ショット照射した状態を示す光学顕微鏡写真である。写真中央にレーザービームの照射痕が確認される。

【0082】

図10は、波長が308nmのXeClエキシマレーザーを紙面の左右方向に延長する幅500 μ mの線状のレーザービームとし、これを非晶質珪素膜に照射した場合のものである。

【0083】

図 1 0 において使用した線状レーザービームは、幅方向および線方向に分割する光学系として用いた石英製シリンドリカルレンズ群のシリンドリカルレンズの一部を石英製のすりガラスに置換した光学系を用いて加工した。そして、不規則な形状のレーザービームが分割する光学系に入射することを防止した。

【 0 0 8 4 】

図 1 0 から、概略長方形のレーザービームの周縁部を除去することにより、線状レーザービームの線方向のエネルギー分布が一様になっていることが確認される。

【 0 0 8 5 】

図 1 1 は、図 1 0 を模式的に示した図である。図 1 1 で示すように、線状レーザービーム 1 1 0 1 により形成される高エネルギー密度領域 1 1 0 2 と低エネルギー密度領域 1 1 0 3 の境界が直線であり、幅方向のエネルギー分布の断面形状がどこでも等しいことがわかる。なお、本実施例において、領域 1 1 0 3 ができる原因は、レンズの加工精度や位置決めの精度にある。

【 0 0 8 6 】

しかし、図 1 および図 2 に比べて、高エネルギー密度領域 1 1 0 2 が非常に広くなっているのでより均一なレーザーアニールが可能である。

【 0 0 8 7 】

〔実施例 2〕

本実施例では、多結晶珪素膜を作製する際に、レーザーアニールを使用する例である。まず、レーザー照射される膜の作製方法を示す。レーザー照射される膜は、本実施例では次の 3 種類の膜を示す。いずれの膜に対しても、本発明は効果的である。

【 0 0 8 8 】

まず、3 種類いずれの膜も、基板として、1 2 7 m m 角のコーニング 1 7 3 7 ガラス基板上に、基板からの不純物の拡散を防止するための下地膜として、窒化珪素膜をシランとアンモニアを原料ガスに用いたプラズマ C V D 法により 2 0 0 n m 以上の厚さに成膜し、熱処理を施し膜質を向上させた。

【 0 0 8 9 】

更に、第二の下地膜と非晶質珪素膜とをプラズマCVD法を用いて連続成膜（前の成膜後大気に曝すことなく次の成膜を行うこと）する。第二の下地膜として、酸化珪素膜（ SiO_x ）、窒化珪素膜（ SiN_x ）または窒化酸化珪素膜（ SiO_xNy ）を10～100nm、本実施例では酸化珪素膜を50nmを形成した。非晶質珪素膜は10～100nm、本実施例では50nmの厚さに成膜する。この膜を今後、出発膜と呼ぶ。

【0090】

（膜Aの作製手順）

出発膜を、450℃の熱浴に1時間さらす。本工程は非晶質珪素膜中の水素濃度を減らすための工程である。膜中の水素が多すぎると膜がレーザーエネルギーに対して耐えきれないので本工程が必要とされる。

【0091】

膜内の水素の密度は 10^{20} 原子/cm³オーダーが適当である。この脱水素化された非晶質珪素膜を非単結晶珪素膜Aと呼ぶ。

【0092】

（膜Bの作製手順）

10ppmの酢酸ニッケル水溶液が、スピンコート法により、出発膜上に塗布され、酢酸ニッケル層が形成される。酢酸ニッケル水溶液には、界面活性剤を添加するとより好ましい。酢酸ニッケル層は、極めて薄いので、膜状となっているとは限らないが、以後の工程において問題はない。

【0093】

次に、上記のようにして各膜が積層された基板に、600℃で4時間の熱アニールを施す。すると、非晶質珪素膜が結晶化し、結晶性珪素膜である非単結晶珪素膜Bが形成される。

【0094】

このとき、触媒元素であるニッケルが結晶成長の核の役割を果たし、結晶化が促進される。600℃、4時間という低温、短時間で結晶化を行うことができるのは、ニッケルの機能による。詳細については、特開平6-244104号に記載されている。

【0095】

触媒元素の濃度は、 $1 \times 10^{15} \sim 10^{19}$ 原子/cm³であると好ましい。 10^{19} 原子/cm³以上の高濃度では、結晶性珪素膜に金属的性質が現れ、半導体としての特性が消滅する。本実施例において、結晶性珪素膜中の触媒元素の濃度は、 $1 \times 10^{17} \sim 10^{18}$ 原子/cm³である。これらの値は、2次イオン質量分析法（SIMS）により分析、測定したものである。

【0096】

（膜Cの作製手順）

出発膜の上からさらに酸化珪素膜を70 nmの厚さに成膜する。成膜方法はプラズマCVD法を用いる。

【0097】

次に該酸化珪素膜の一部をフォトリソパターニング工程によって完全に開孔する。

【0098】

さらに、該開孔部に薄い酸化膜を形成するために酸素雰囲気中でUV光を5分間照射する。この薄い酸化膜は、後に導入するニッケル水溶液に対する上記開孔部の濡れ性改善のために形成されるものである。

【0099】

次に100 ppmの酢酸ニッケル水溶液が、スピコート法により、該膜上に塗布され、酢酸ニッケルが上記開孔部分に入る。酢酸ニッケル水溶液には、界面活性剤を添加するとより好ましい。

【0100】

次に、600℃で8時間の熱アニールが施され、ニッケル導入部分から横方向に結晶が成長してゆく。このとき、ニッケルが果たす役割は膜Bと同様のものがある。今回の条件では横成長量として40 μm程度が得られる。

【0101】

このようにして非晶質珪素膜が結晶化し、結晶性珪素膜である非単結晶珪素膜Cが形成される。その後、非単結晶珪素膜C上の酸化珪素膜をバッファーフッ酸を用い剥離除去する。

【0 1 0 2】

このようにして得られる非単結晶珪素膜 A、B、C に、エキシマレーザーを用いたレーザーアニールを行う。

【0 1 0 3】

図 8 に、本実施例におけるレーザー照射装置を示す。図 8 は、レーザー照射装置の概観である。

【0 1 0 4】

図 8 において、レーザービームは、ビーム発生装置 8 0 1 から照射され、反射ミラー 8 0 2 によりレーザービームの進行方向を調整後、光学系 8 0 3、8 0 8 により、断面形状が線状に加工される。反射ミラー 8 0 7 は、レーザービームを反射して、被処理基板 8 0 9 にレーザービームを照射する。反射ミラー 8 0 2 の間には、レーザービームの広がり角を抑え、かつ、ビームの大きさを調整できるビームエキスパンダーを挿入してもよい。

【0 1 0 5】

そして、被処理基板 8 0 9 を保持している照射ステージ 8 0 5 は、線状レーザービームの幅方向に移動することができる。

【0 1 0 6】

本実施例における光学系 8 0 3 は、分割する光学系の直前に図 6 で示すようにスリット 6 1 0 を設け、入射するレーザービームの周縁部を除去し長方形にしている。

【0 1 0 7】

このような装置を用いて以下のようなレーザービームの加工を行った。

【0 1 0 8】

ビーム発生装置 8 0 1 は、ここでは、XeCl エキシマレーザー（波長 3 0 8 nm）を発振するものを用いる。他に、KrF（波長 2 4 8 nm）、ArF（波長 1 9 3 nm）、KrCl（波長 2 2 2 nm）等のエキシマレーザーを用いてもよいし、Ar レーザー、YAG レーザー等も用いることは可能である。。

【0 1 0 9】

ビーム発生装置から射出されたレーザービームは、分割する光学系の直前では

およそ 1 5 m m × 4 5 m m の大きさとなっている。

【 0 1 1 0 】

分割する光学系の直前に配置したスリットは 1 2 m m × 3 5 m m であり、レーザービームの周縁部を除去し長方形とした。

【 0 1 1 1 】

そして、長方形のレーザービームの分割する方向と垂直な端辺と、分割するシリンドリカルレンズ群のシリンドリカルレンズ同士の境界とを平行とした。

【 0 1 1 2 】

線方向に分割するシリンドリカルレンズ群は、各シリンドリカルレンズの幅が 5 m m の合成石英からなるシリンドリカルレンズを 7 段並列に並べたシリンドリカルレンズ群を用いた。

【 0 1 1 3 】

また、幅方向に分割するシリンドリカルレンズ群は、各シリンドリカルレンズの幅が 2 m m の合成石英からなるシリンドリカルレンズを 6 段並列に並べたシリンドリカルレンズ群を用いた。

【 0 1 1 4 】

シリンドリカルレンズ群は、その中心が入射するレーザービームの中心と揃うように配置した。

【 0 1 1 5 】

こうして分割されたレーザービームは、重ね合わせるための光学系を経て、被処理基板 8 0 9 上に幅 0 . 1 ~ 1 m m 、長さ 1 0 0 ~ 3 0 0 m m の大きさに加工される。本実施例では、幅 0 . 4 m m 、長さ 1 3 5 m m の大きさの線状レーザービームを得た。

【 0 1 1 6 】

ここで、長方形のレーザービームの短辺と、シリンドリカルレンズ群の線方向の端部とを一致させた。また、長方形のレーザービームの長辺と、シリンドリカルレンズ群の幅方向の端部とを一致させた。このため、被照射面におけるレーザービームのエネルギー分布の断面形状が、長方形のレーザービームを得ることができた。

【0117】

次に、図12に示す装置の説明をする。ロード／アンロード室1205に、被処理基板809が多数枚、例えば20枚収納されたカセット1203が配置される。ロボットアーム1204により、カセット1203から一枚の基板がアライメント室1202に移動される。

【0118】

アライメント室1202には、被処理基板809とロボットアーム1204との位置関係を修正するための、アライメント機構が配置されている。

【0119】

基板は、ロボットアーム1204によって基板搬送室1201に運ばれ、さらにロボットアーム1204によって、レーザー照射室1206に移送される。

【0120】

図8において、被処理基板809上に照射される線状レーザービームは、幅0.4mm×長さ135mmである。

【0121】

被照射面におけるレーザービームのエネルギー密度は、 $100\text{ mJ/cm}^2 \sim 500\text{ mJ/cm}^2$ の範囲で、本実施例では 350 mJ/cm^2 とする。照射ステージ805を 1.2 mm/s で一方向に移動させながら行うことで、線状レーザービームを走査させる。

【0122】

レーザーの発振周波数は30Hzとし、被照射物の一点に注目すると、10ショットのレーザービームが照射される。前記ショット数は5ショットから50ショットの範囲で適当に選ぶ。

【0123】

レーザー照射終了後、被処理基板809はロボットアーム1204によって基板搬送室1201に引き戻される。

【0124】

そして、被処理基板809は、ロボットアーム1204によって、ロード／アンロード室1205に移送され、カセット1203に収納される。

【0 1 2 5】

こうして、レーザーアニール工程が終了する。このようにして、上記工程を繰り返すことにより、多数の基板に対して、連続的に一枚ずつ処理できる。

【0 1 2 6】

図 1 2 のレーザー照射システムにおいて、装置の小スペース化のためロード／アンロード室 1 2 0 5 は一つのチャンバーで兼ねているが、生産性を上げるためアンロード室を別に設ける構成としてもよい。

【0 1 2 7】

その場合、基板搬送室 1 2 0 1 に第二のアライメント室を設け、第二のアライメント室に接続したアンロード室を設ける構成でも生産性は向上されるが、レーザー照射室 1 2 0 6 に第二の基板搬送室を設け、レーザー照射終了後の被処理基板を第二の基板搬送室のロボットアームによって第二のアライメント室およびアンロード室に移送する構成であれば更に効果がある。

【0 1 2 8】

本実施例は線状レーザービームを用いたが、線状から正形状にいたるまでいづれのビーム形状を本発明に使用しても本発明が特徴とする効果がある。

【0 1 2 9】

このレーザー照射装置を用いて、非単結晶珪素膜 A、B、C をレーザーアニールした結果、非単結晶珪素膜 A は、基板全面に均一なレーザー結晶化された多結晶珪素膜を得ることができた。

【0 1 3 0】

また、非単結晶珪素膜 B、C は、基板全面の珪素膜の結晶性が向上し、レーザーアニール前に比べて高い電界効果移動度を有する多結晶珪素膜を得ることができた。

【0 1 3 1】

本実施例によって得られた多結晶珪素膜を、液晶ディスプレイのスイッチング素子として機能する T F T のソース、ドレイン、チャネル領域を含む半導体層として利用した場合、従来と比較してレーザーの加工あとが目立たないものできた。

【0 1 3 2】

〔実施例 3〕

本実施例においては、概略長形状のレーザービームの周縁部を除去する方法として、分割する光学系であるシリンドリカルレンズ群の不規則な形状のレーザービームが入射するシリンドリカルレンズを遮光した。

【0 1 3 3】

実施例 2 に示される方法を採用すると、長方形のスリットの短辺と長辺とを、分割する各方向と平行に配置する必要がある、配置のずれによって、分割する光学系に不規則な形状のレーザービームの入射が起こる虞がある。しかしながら、本実施例では、分割する光学系の不規則な形状のレーザービームが入射するシリンドリカルレンズを遮光するため、上記の問題を解消することができる。

【0 1 3 4】

本実施例では、実施例 2 のレーザー照射装置において、スリット 6 0 1 をはずし、シリンドリカルレンズ群の一部のシリンドリカルレンズを遮光した構成のレーザー照射装置を用いた。

【0 1 3 5】

ビーム発生装置から射出されたレーザービームは、分割する光学系の直前ではおよそ 1 5 m m × 4 5 m m の大きさとなっている。

【0 1 3 6】

幅方向に分割するシリンドリカルレンズ群は、各シリンドリカルレンズの幅が 2 m m の合成石英からなるシリンドリカルレンズを 8 段並列に並べたシリンドリカルレンズ群を用いた。そして、シリンドリカルレンズ群は、その中心が入射するレーザービームの中心と揃うように配置され、その両端のシリンドリカルレンズを石英製のすりガラスにより遮光して、入射するレーザービームの幅方向の周縁部を除去することができた。

【0 1 3 7】

線方向に分割するシリンドリカルレンズ群は、各シリンドリカルレンズの幅が 6 m m の合成石英からなるシリンドリカルレンズを 9 段並列に並べたシリンドリカルレンズ群を用いた。そして、シリンドリカルレンズ群は、その中心が入射す

るレーザービームの中心と揃うように配置され、その両端のシリンドリカルレンズを石英製のすりガラスにより遮光して、入射するレーザービームの線方向の周縁部を除去することができた。

【0 1 3 8】

このようにして、本実施例ではその分割する方向に関して、分割する光学系の幅が入射するレーザービームの幅よりも短くすることにより、周縁部の除去を行った。

【0 1 3 9】

本実施例では、シリンドリカルレンズ群の両端のシリンドリカルレンズを遮光する構成としたが、その分割する方向に関して、シリンドリカルレンズ群の幅が入射するレーザービームの幅よりも短いシリンドリカルレンズ群を使用してもよい。その際、シリンドリカルレンズ群の周囲には、入射しなかったレーザービームを遮光するため遮光板を設けることが好ましい。また、遮光板によってシリンドリカルレンズ群を支持してもよい。

【0 1 4 0】

こうして分割されたレーザービームは、重ね合わせるための光学系を経て、被処理基板上に幅 $400\mu\text{m}$ 、長さ 13.5cm の大きさに加工した。

【0 1 4 1】

このレーザー照射装置を用いて、非単結晶珪素膜 A、B、C をレーザーアニールした結果、非単結晶珪素膜 A は、基板全面に均一なレーザー結晶化された多結晶珪素膜を得ることができた。

【0 1 4 2】

また、非単結晶珪素膜 B、C は、基板全面の珪素膜の結晶性が向上し、レーザーアニール前に比べて高い電界効果移動度を有する多結晶珪素膜を得ることができた。

【0 1 4 3】

本実施例によって得られた多結晶珪素膜を、液晶ディスプレイのスイッチング素子として機能する TFT のソース、ドレイン、チャネル領域を含む半導体層として利用した場合、従来と比較してレーザーの加工あとが目立たないものができる。

た。

【0 1 4 4】

〔実施例 4〕

本実施例では、レーザービームの幅よりも短いシリンドリカルレンズ群を用いて、レーザービームを分割し、不規則な形状のレーザービームが入射するシリンドリカルレンズをなくした。

【0 1 4 5】

また、本実施例のレーザー照射装置は、幅方向のビームホモジナイザーの光学系に組合せシリンドリカルレンズ群を用いてレンズの収差を減らした構成を採っている。このような構成を採ることにより、線状レーザービームの被照射面における幅方向のエネルギー分布のボケ領域を $25\ \mu\text{m}$ 以下としそのエッジを垂直に近くできる。ボケ領域とは、最大エネルギーの $90\sim 5\%$ の領域をさす。

【0 1 4 6】

図 8 に、本実施例におけるレーザー照射装置を示す。図 8 は、レーザー照射装置の概観である。

【0 1 4 7】

図 8 において、レーザー照射装置は、レーザービーム発生装置 8 0 1 から照射され、反射ミラー 8 0 2 によりレーザーの進行方向を調整後、光学系 8 0 3、8 0 8 により、断面形状が線状に加工される。反射ミラー 8 0 7 は、パルスレーザービームを反射して、被処理基板 8 0 9 にレーザービームを照射する。反射ミラー 8 0 2 の間には、レーザービームの広がり角を抑え、かつ、ビームの大きさを調整できるビームエキスパンダーを挿入してもよい。

【0 1 4 8】

そして、被処理基板 8 0 9 を保持している照射ステージ 8 0 5 は、線状レーザービームの幅方向に移動することができる。

【0 1 4 9】

本実施例における光学系 8 0 3、反射ミラー 8 0 7、およびシリンドリカルレンズ 8 0 8 は図 1 3 に示す構造である。

【0 1 5 0】

図 1 3 において、入射したレーザービームは、シリンドリカルレンズ群 1 4 0 2 により線方向に分割され、凸メニスカスシリンドリカルレンズと平凸シリンドリカルレンズとの組合せシリンドリカルレンズ群 1 4 0 3 により幅方向に分割される。

【0 1 5 1】

本実施例では、幅方向にレーザービームを分割する光学レンズとして、図 1 3 に示す構造を用いたが、他の組合せシリンドリカルレンズ群を用いても、非球面に加工して収差をほとんど無くしたシリンドリカルレンズ群を用いてもボケ領域を少なくすることが可能であり、エッジを垂直に近くすることができる。

【0 1 5 2】

そして、トリプレットタイプの対称型レンズからなる光学レンズ 1 4 0 4 により分割されたレーザービームを重ね合わせ均一化し、スリット 1 4 0 5、シリンドリカルレンズ 1 4 0 6 を経て、テッサータイプの対称型レンズからなる光学レンズ 1 4 0 8 によりレーザービームを幅方向に関して被処理基板 1 4 0 9 に重ね合わせる。

【0 1 5 3】

本実施例では、光学レンズ 1 4 0 4、1 4 0 8 に対称型レンズを用いたが、他の組合せレンズを用いても、非球面レンズとして収差をほとんどなくした構成としてもよい。

【0 1 5 4】

また、スリット 1 4 0 5 は、必ずしも必要ではなく、線状レーザービームの幅を細く調節するとき用いた。

【0 1 5 5】

このような装置を用いて以下のようなレーザービームの加工を行った。

【0 1 5 6】

レーザービーム発生装置 1 4 0 1 は、ここでは、X e C l エキシマレーザー（波長 3 0 8 n m）を発振するものを用いた。他に、K r F エキシマレーザー（波長 2 4 8 n m）、A r F（波長 1 9 3 n m）、K r C l（波長 2 2 2 n m）等を用いてもよい。

【0 1 5 7】

レーザー発生装置から射出されたレーザービームの幅方向の長さはおよそ 1 6 mm 程度であった。該レーザービームを幅方向に分割する光学レンズに入射させる。

【0 1 5 8】

光学レンズ 1 4 0 3 は、各レンズの幅が 2 mm の合成石英からなるシリンドリカルレンズを 7 段並列に並べたシリンドリカルレンズ群に、同じく 2 mm 幅の合成石英からなり、凸凸面を有するシリンドリカルレンズを 7 段並列に並べたシリンドリカルレンズ群を組合せた構成を用いた。図 1 3 中では、光学レンズが 4 段しか記載していないが、これは図を簡略化したためである。

【0 1 5 9】

上記のように光学レンズ 1 4 0 3 は、入射するレーザービームの幅 1 6 mm よりも小さい 1 4 mm の幅しかなく、入射したレーザービームの端部は使用していない。

【0 1 6 0】

入射したレーザービームの端部は不均一なエネルギーを有しており、均一性を高めるためにレーザービームの端部は使用しない方が好ましい。

【0 1 6 1】

こうして幅方向に分割されたレーザービームは、光学レンズ 1 4 0 4 および光学レンズ 1 4 0 8 を経て、基板上に幅 3 0 0 ~ 1 0 0 0 μ m の幅に加工される。レーザービームの幅は、光学レンズ 1 4 0 4 と 1 4 0 8 の間の距離を調節することで変えることができる。

【0 1 6 2】

こうして加工された線状レーザービームは、幅方向に関して、レンズの収差をほとんど受けないためエネルギー分布のエッジが垂直な線状レーザービームとなる。

【0 1 6 3】

本実施例において、被処理基板 8 0 9 上に照射される線状レーザービームは、幅 0. 4 mm \times 長さ 1 3 5 mm である。

【0 1 6 4】

被照射面におけるレーザービームのエネルギー密度は、 $100\text{ mJ/cm}^2 \sim 500\text{ mJ/cm}^2$ の範囲で、本実施例では 350 mJ/cm^2 とした。照射ステージ805を 1.2 mm/s で一方向に移動させながら行うことで、線状レーザービームを走査させた。

【0 1 6 5】

レーザーの発振周波数は 30 Hz とし、被照射物の一点に注目すると、10ショットのレーザービームが照射される。前記ショット数は5ショットから50ショットの範囲で適当に選ぶ。

【0 1 6 6】

こうして、レーザーアニール工程が終了する。このようにして、上記工程を繰り返すことにより、多数の基板に対して、連続的に一枚ずつ処理できる。

【0 1 6 7】

本実施例は線状レーザーを用いたが、線状から正形状にいたるまでいずれのビーム形状を本発明に使用しても本発明が特徴とする効果がある。

【0 1 6 8】

このレーザー照射装置を用いて、非単結晶珪素膜A、B、Cをレーザーアニールした結果、非単結晶珪素膜Aは、基板全面に均一なレーザー結晶化された多結晶珪素膜を得ることができた。

【0 1 6 9】

また、非単結晶珪素膜B、Cは、基板全面の珪素膜の結晶性がさらに促進され、高い移動度を有する多結晶珪素膜を得ることができた。

【0 1 7 0】

しかも、光学レンズに組合せレンズを用いることにより、TFTの特性が周期的にばらつく縞現象を防止することが可能である。従来の光学系と比較した縞の防止は、本実施例で得られた珪素膜を画素スイッチング素子に用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置とした際に顕著に確認することができる。

【0 1 7 1】

本実施例では、光学レンズ1404、1408に対称型レンズを用いたが、他

の組合せレンズを用いても、非球面レンズとして収差をほとんどなくした構成としてもよい。

【0 1 7 2】

本実施例では、光学レンズ 1 4 0 4 および 1 4 0 8 に組合せレンズを用いて、収差を減らしたが、光学レンズ 1 4 0 8 のみを組合せレンズとし、光学レンズ 1 4 0 4 にはシリンドリカルレンズ単体としても縞形成を緩和することが可能であった。

【0 1 7 3】

上記レーザーアニールされた珪素膜を活性層とする T F T を作製すると、Nチャネル型、Pチャネル型、いずれも作製できる。

【0 1 7 4】

また、Nチャネル型とPチャネル型とを組み合わせた構造も得ることが可能である。また、多数の T F T を集積化して電気回路を構成することもできる。

【0 1 7 5】

上記非単結晶珪素膜 A、B、C は、平坦なガラス基板に設けられているが、非単結晶珪素膜 A、B、C の被形成面が配線などにより凹凸形状であっても本レーザーアニールは有効である。

【0 1 7 6】

本発明の光学系を介してレーザーアニールされた半導体膜を利用して、T F T を有する液晶ディスプレイを作製した場合、個々の T F T 特性のバラツキの少ない高画質なものが得られる。

【0 1 7 7】

以上のことは、他の実施例で示した光学系を介してレーザーアニールされた半導体膜についてもいえる。

【0 1 7 8】

〔実施例 5〕

本実施例では、1 c m × 1 c m の正形状に加工したレーザービームを用いて、非単結晶珪素膜 A、B、C をレーザーアニールする。

【0 1 7 9】

正形状に加工するための光学系を図 1 4 に示す。入射レーザービーム 1 3 0 1 の向きは、シリンドリカルレンズ群 1 3 0 2 および 1 3 0 3 に対して垂直であることが好ましい。

【0 1 8 0】

入射レーザービーム 1 3 0 1 は、シリンドリカルレンズ群 1 3 0 2 によって X 軸方向に分割され、シリンドリカルレンズ群 1 3 0 3 によって Y 軸方向（X 軸方向と Y 軸方向は線状レーザービームで言う線方向と幅方向に対応している）に分割される。

【0 1 8 1】

そして、分割されたレーザービームは、シリンドリカルレンズ 1 3 0 6 によって X 軸方向に関して被処理面 1 3 0 9 で重ね合わされ、シリンドリカルレンズ 1 3 0 4 によって Y 軸方向に関して被処理面 1 3 0 9 で重ね合わされる。

【0 1 8 2】

また、本実施例で使用するレーザー処理装置は、照射ステージが X 軸方向および Y 軸方向の 2 方向に移動する手段を有している。

【0 1 8 3】

以上の光学系を用いて、レーザービームを被処理基板で 1 0 × 1 0 m m の正形状に加工し、非単結晶珪素膜 A、B、C をレーザーアニールする。被照射面におけるレーザービームのエネルギー密度は 3 5 0 m J / c m 2 とした。

【0 1 8 4】

その結果、非単結晶珪素膜 A は、基板全面をほぼ均一にレーザー結晶化された多結晶珪素膜を得ることができた。

【0 1 8 5】

また、非単結晶珪素膜 B、C は、基板全面の珪素膜の結晶性が向上し、レーザーアニール前に比べて高い電界効果移動度を有する多結晶珪素膜を得ることができた。

【0 1 8 6】

[実施例 6]

本発明の実施例について図 1 5 ～ 図 1 8 を用いて説明する。ここでは、実施例

1ないし3において得られた半導体膜を利用する液晶表示装置の画素部とその周辺に設けられる駆動回路を同時に作製する方法について説明する。但し、説明を簡単にするために、駆動回路に関しては、シフトレジスタ回路、バッファ回路等の基本回路であるCMOS回路と、サンプリング回路を形成するnチャネル型TFTとを図示することとする。

【0187】

図15(A)において、基板3101には、ガラス基板や石英基板を使用することが望ましい。その他にもシリコン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したものを基板としても良い。耐熱性が許せばプラスチック基板を用いることも可能である。

【0188】

そして、基板3101のTFTが形成される表面には、珪素（シリコン）を含む絶縁膜（本実施例中では酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、または窒化酸化シリコン膜の総称を指す）からなる下地膜3102をプラズマCVD法やスパッタ法で100～400nmの厚さに形成する。なお、本実施例中において窒化酸化シリコン膜とはSiO_xN_yで表される絶縁膜であり、珪素、酸素、窒素を所定の割合で含む絶縁膜を指す。

【0189】

本実施例では、下地膜3102として、窒化酸化シリコン膜を25～100nm、ここでは50nmの厚さに、酸化シリコン膜を50～300nm、ここでは150nmの厚さとした2層構造で形成した。下地膜3101は基板からの不純物汚染を防ぐために設けられるものであり、石英基板を用いた場合には必ずしも設けなくても良い。

【0190】

次に下地膜3101の上に20～100nmの厚さの、非晶質構造を含む半導体膜（本実施例では非晶質シリコン膜（図示せず））を公知の成膜法で形成した。なお、非晶質構造を含む半導体膜としては、非晶質半導体膜、微結晶半導体膜があり、さらに非晶質シリコンゲルマニウム膜などの非晶質構造を含む化合物半導体膜も含まれる。

【0191】

そして、特開平7-130652号公報（USP5, 643, 826号に対応）に記載された技術に従って、結晶構造を含む半導体膜（本実施例では結晶質シリコン膜）3102を形成した。同公報記載の技術は、非晶質シリコン膜の結晶化に際して、結晶化を助長する触媒元素（ニッケル、コバルト、ゲルマニウム、錫、鉛、パラジウム、鉄、銅から選ばれた一種または複数種の元素、代表的にはニッケル）を用いる結晶化手段である。

【0192】

具体的には、非晶質シリコン膜表面に触媒元素を保持させた状態で加熱処理を行い、非晶質シリコン膜を結晶質シリコン膜に変化させるものである。本実施例では同公報の実施例1に記載された技術を用いるが、実施例2に記載された技術を用いても良い。なお、結晶質シリコン膜には、いわゆる単結晶シリコン膜も多結晶シリコン膜も含まれるが、本実施例で形成される結晶質シリコン膜は結晶粒界を有するシリコン膜である。（図15（A））

【0193】

非晶質シリコン膜は含有水素量にもよるが、好ましくは400～550℃で数時間加熱して脱水素処理を行い、含有水素量を5atom%以下として、結晶化の工程を行うことが望ましい。また、非晶質シリコン膜をスパッタ法や蒸着法などの他の作製方法で形成しても良いが、膜中に含まれる酸素、窒素などの不純物元素を十分低減させておくことが望ましい。

【0194】

ここでは、下地膜と非晶質シリコン膜とは、同じ成膜法で形成することが可能であるので両者を連続形成しても良い。下地膜を形成後、一旦大気雰囲気中にさらされないようにすることで表面の汚染を防ぐことが可能となり、作製されるTF Tの特性バラツキを低減させることができる。

【0195】

次に、実施例1ないし3に示す方法で結晶質シリコン膜3102に対してレーザーアニールを施して結晶性の改善された結晶質シリコン膜3103を形成する。レーザー光としては、パルス発振型または連続発振型のエキシマレーザー光が

望ましいが、連続発振型のアルゴンレーザー光でも良い。(図15(B))

【0196】

本実施例では、実施例2で示す光学系を用いてパルス発振型エキシマレーザー光を線状に加工してレーザーアニール工程を行った。レーザーアニール条件は、励起ガスとしてXeClガスを用い、処理温度を室温、パルス発振周波数を30Hzとし、レーザーエネルギー密度を250~500mJ/cm²(代表的には350~400mJ/cm²)とした。

【0197】

上記条件で行われたレーザーアニール工程は、熱結晶化後に残存した非晶質領域を完全に結晶化すると共に、既に結晶化された結晶質領域の欠陥等を低減する効果を有する。そのため、本工程は光アニールにより半導体膜の結晶性を改善する工程、または半導体膜の結晶化を助長する工程と呼ぶこともできる。このような効果はレーザーアニールの条件を最適化することによっても得ることが可能である。本実施例中ではこのような条件を第1アニール条件と呼ぶことにする。

【0198】

次に、結晶質シリコン膜3103上に後の不純物添加時のために保護膜3104を形成した。保護膜3104は100~200nm(好ましくは130~170nm)の厚さの窒化酸化シリコン膜または酸化シリコン膜を用いた。この保護膜3104は不純物添加時に結晶質シリコン膜が直接プラズマに曝されないようにするためと、微妙な濃度制御を可能にするための意味がある。

【0199】

そして、その上にレジストマスク3105を形成し、保護膜3104を介してp型を付与する不純物元素(以下、p型不純物元素という)を添加した。p型不純物元素としては、代表的には13族に属する元素、典型的にはボロンまたはガリウムを用いることができる。この工程(チャネルドープ工程という)はTFITのしきい値電圧を制御するための工程である。なお、ここではジボラン(B₂H₆)を質量分離しないでプラズマ励起したイオンドープ法でボロンを添加した。勿論、質量分離を行うイオンインプランテーション法を用いても良い。

【0200】

この工程により $1 \times 10^{15} \sim 1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ (代表的には $5 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{17} \text{ atoms/cm}^3$) の濃度で p 型不純物元素 (本実施例ではボロン) を含む不純物領域 3 1 0 6 を形成した。なお、本実施例中では少なくとも上記濃度範囲で p 型不純物元素を含む不純物領域を p 型不純物領域 (b) と定義する。(図 1 5 (C))

【0 2 0 1】

次に、レジストマスク 3 1 0 5 を除去し、新たにレジストマスク 3 1 0 7 ~ 3 1 1 0 を形成した。そして、n 型を付与する不純物元素 (以下、n 型不純物元素という) を添加して n 型を呈する不純物領域 3 1 1 1 ~ 3 1 1 3 を形成した。なお、n 型不純物元素としては、代表的には 1 5 族に属する元素、典型的にはリンまたは砒素を用いることができる。(図 1 5 (D))

【0 2 0 2】

この低濃度不純物領域 3 1 1 1 ~ 3 1 1 3 は、後に CMOS 回路およびサンプリング回路の n チャネル型 TFT において、LDD 領域として機能させるための不純物領域である。なお、ここで形成された不純物領域には n 型不純物元素が $2 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ (代表的には $5 \times 10^{17} \sim 5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$) の濃度で含まれている。本実施例中では上記濃度範囲で n 型不純物元素を含む不純物領域を n 型不純物領域 (b) と定義する。

【0 2 0 3】

なお、ここではフォスフィン (PH_3) を質量分離しないでプラズマ励起したイオンドープ法でリンを $1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度で添加した。勿論、質量分離を行うイオンインプランテーション法を用いても良い。この工程では、保護膜 3 1 0 7 を介して結晶質シリコン膜にリンを添加した。

【0 2 0 4】

次に、保護膜 3 1 0 4 を除去し、再び実施例 1 ないし 3 に示す方法でレーザービームの照射工程を行う。本実施例では、実施例 2 で示す光学系を用いてレーザーアニールを行った。レーザービームとしては、パルス発振型または連続発振型のエキシマレーザー光が望ましいが、連続発振型のアルゴンレーザー光でも良い。但し、添加された不純物元素の活性化が目的であるので、結晶質シリコン膜が

溶融しない程度のエネルギーで照射することが好ましい。また、保護膜 3 1 0 4 をつけたままレーザーアニール工程を行うことも可能である。(図 1 5 (E))

【0 2 0 5】

本実施例では、パルス発振型エキシマレーザー光を線状に加工してレーザーアニール工程を行った。レーザーアニール条件は、励起ガスとして Kr F ガスを用い、処理温度を室温、パルス発振周波数を 3 0 H z とし、レーザーエネルギー密度を 1 0 0 ~ 3 0 0 mJ/cm² (代表的には 1 5 0 ~ 2 5 0 mJ/cm²) とした。

【0 2 0 6】

上記条件で行われたレーザーアニール工程は、添加された n 型または p 型を付与する不純物元素を活性化すると共に、不純物元素の添加時に非晶質化した半導体膜を再結晶化する効果を有する。なお、上記条件は半導体膜を溶融させることなく原子配列の整合性をとり、且つ、不純物元素を活性化することが好ましい。また、本工程はレーザーアニールにより n 型または p 型を付与する不純物元素を活性化する工程、半導体膜を再結晶化する工程、またはそれらを同時に行う工程と呼ぶこともできる。本実施例中ではこのような条件を第 2 アニール条件と呼ぶことにする。

【0 2 0 7】

この工程により n 型不純物領域 (b) 3 1 1 1 ~ 3 1 1 3 の境界部、即ち、n 型不純物領域 (b) の周囲に存在する真性な領域 (p 型不純物領域 (b) も実質的に真性とみなす) との接合部が明確になる。このことは、後に T F T が完成した時点において、L D D 領域とチャネル形成領域とが非常に良好な接合部を形成しうることを意味する。

【0 2 0 8】

なお、このレーザービームによる不純物元素の活性化に際して、熱処理による活性化を併用しても構わない。熱処理による活性化を行う場合は、基板の耐熱性を考慮して 4 5 0 ~ 5 5 0 ℃ 程度の熱処理を行えば良い。

【0 2 0 9】

次に、結晶質シリコン膜の不要な部分を除去して、島状の半導体膜 (以下、活性層という) 3 1 1 4 ~ 3 1 1 7 を形成した。(図 1 5 (F))

【0210】

次に、活性層 3114～3117 を覆ってゲート絶縁膜 3118 を形成した。ゲート絶縁膜 3118 は、10～200 nm、好ましくは 50～150 nm の厚さに形成すれば良い。本実施例では、プラズマ CVD 法で N_2O と SiH_4 を原料とした窒化酸化シリコン膜を 115 nm の厚さに形成した。(図 16 (A))

【0211】

次に、ゲート配線となる導電膜を形成した。なお、ゲート配線は単層の導電膜で形成しても良いが、必要に応じて二層、三層といった積層膜とすることが好ましい。本実施例では、第 1 導電膜 3119 と第 2 導電膜 3120 とでなる積層膜を形成した。(図 16 (B))

【0212】

ここで第 1 導電膜 3119、第 2 導電膜 3120 としては、タンタル (Ta)、チタン (Ti)、モリブデン (Mo)、タングステン (W)、クロム (Cr)、シリコン (Si) から選ばれた元素、または前記元素を主成分とする導電膜(代表的には窒化タンタル膜、窒化タングステン膜、窒化チタン膜)、または前記元素を組み合わせた合金膜(代表的には Mo-W 合金、Mo-Ta 合金)を用いることができる。

【0213】

なお、第 1 導電膜 3119 は 10～50 nm (好ましくは 20～30 nm) とし、第 2 導電膜 3120 は 200～400 nm (好ましくは 250～350 nm) とすれば良い。本実施例では、第 1 導電膜 3119 として、50 nm 厚の窒化タングステン (WN) 膜を、第 2 導電膜 3120 として、350 nm 厚のタングステン膜を用いた。

【0214】

なお、図示しないが、第 1 導電膜 3119 の下にシリコン膜を 2～20 nm 程度の厚さで形成しておくことは有効である。これによりその上に形成される導電膜の密着性の向上と、酸化防止を図ることができる。

【0215】

次に、第 1 導電膜 3119 と第 2 導電膜 3120 とを一括でエッチングして 4

0 0 n m 厚のゲート配線 3 1 2 1 ~ 3 1 2 4 を形成した。この時、駆動回路に形成されるゲート配線 3 1 2 2、3 1 2 3 は n 型不純物領域 (b) 3 1 1 1 ~ 3 1 1 3 の一部とゲート絶縁膜を介して重なるように形成した。この重なった部分が後に Lov 領域となる。なお、ゲート配線 3 1 2 4 は断面では二つに見えるが、実際は連続的に繋がった一つのパターンから形成されている。(図 1 6 (C))

【0 2 1 6】

次に、ゲート配線 3 1 2 1 ~ 3 1 2 4 をマスクとして自己整合的に n 型不純物元素 (本実施例ではリン) を添加した。こうして形成された不純物領域 3 1 2 5 ~ 3 3 1 3 0 には前記 n 型不純物領域 (b) の $1/2 \sim 1/10$ (代表的には $1/3 \sim 1/4$) の濃度 (但し、前述のチャネルドープ工程で添加されたボロン濃度よりも $5 \sim 10$ 倍高い濃度、代表的には $1 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 、典型的には $3 \times 10^{17} \sim 3 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 、) でリンが添加されるように調節した。なお、本実施例中では上記濃度範囲で n 型不純物元素を含む不純物領域を n 型不純物領域 (c) と定義する。(図 1 6 (D))

【0 2 1 7】

なお、この工程ではゲート配線で隠された部分を除いて全ての n 型不純物領域 (b) にも $1 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度でリンが添加されているが、非常に低濃度であるため n 型不純物領域 (b) としての機能には影響を与えない。また、n 型不純物領域 (b) 3 1 2 7 ~ 3 1 3 0 には既にチャネルドープ工程で $1 \times 10^{15} \sim 1 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度のボロンが添加されているが、この工程では p 型不純物領域 (b) に含まれるボロンの $5 \sim 10$ 倍の濃度でリンが添加されるので、この場合もボロンは n 型不純物領域 (b) の機能には影響を与えないと考えて良い。

【0 2 1 8】

但し、厳密には n 型不純物領域 (b) 3 1 1 1 ~ 3 1 1 3 のうちゲート配線に重なった部分のリン濃度が $2 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ のままであるのに対し、ゲート配線に重ならない部分はそれに $1 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度のリンが加わっており、若干高い濃度でリンを含むことになる。

【0 2 1 9】

次に、ゲート配線 3 1 2 1 ~ 3 1 2 4 をマスクとして自己整合的にゲート絶縁膜 3 1 1 8 をエッチングした。エッチングはドライエッチング法を用い、エッチングガスとしては CHF_3 ガスを用いた。但し、エッチングガスはこれに限定する必要はない。こうしてゲート配線下にゲート絶縁膜 3 1 3 1 ~ 3 1 3 4 が形成された。(図 1 6 (E))

【0 2 2 0】

このように活性層を露呈させることによって、次に不純物元素の添加工程を行う際に加速電圧を低くすることができる。そのため、また必要なドーズ量が少なく済むのでスループットが向上する。勿論、ゲート絶縁膜をエッチングしないで残し、スルドーピングによって不純物領域を形成しても良い。

【0 2 2 1】

次に、ゲート配線を覆う形でレジストマスク 3 1 3 5 ~ 3 1 3 8 を形成し、n 型不純物元素（本実施例ではリン）を添加して高濃度にリンを含む不純物領域 3 1 3 9 ~ 3 1 4 7 を形成した。ここでも、フォスフィン (PH_3) を用いたイオンドーピング法（勿論、イオンインプランテーション法でも良い）で行い、この領域のリンの濃度は $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ （代表的には $2 \times 10^{20} \sim 5 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ ）とした。(図 1 6 (F))

【0 2 2 2】

なお、本実施例中では上記濃度範囲で n 型不純物元素を含む不純物領域を n 型不純物領域 (a) と定義する。また、不純物領域 3 1 3 9 ~ 3 1 4 7 が形成された領域には既に前工程で添加されたリンまたはボロンが含まれるが、十分に高い濃度でリンが添加されることになるので、前工程で添加されたリンまたはボロンの影響は考えなくて良い。従って、本実施例中では不純物領域 3 1 3 9 ~ 3 1 4 7 は n 型不純物領域 (a) と言い換えても構わない。

【0 2 2 3】

次に、レジストマスク 3 1 3 5 ~ 3 1 3 9 を除去し、新たにレジストマスク 3 1 4 8 を形成した。そして、p 型不純物元素（本実施例ではボロン）を添加し、高濃度にボロンを含む不純物領域 3 1 4 9、3 1 5 0 を形成した。ここではジボラン (B_2H_6) を用いたイオンドーピング法（勿論、イオンインプランテーション法

でも良い) により $3 \times 10^{20} \sim 3 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ (代表的には $5 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$) の濃度でボロンを添加した。なお、本実施例中では上記濃度範囲で p 型不純物元素を含む不純物領域を p 型不純物領域 (a) と定義する。

(図 17 (A))

【0224】

なお、不純物領域 3149、3150 の一部 (前述の n 型不純物領域 (a) 3139、3140) には既に $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度でリンが添加されているが、ここで添加されるボロンはその少なくとも 3 倍以上の濃度で添加される。そのため、予め形成されていた n 型の不純物領域は完全に P 型に反転し、P 型の不純物領域として機能する。従って、本実施例中では不純物領域 3149、3150 を p 型不純物領域 (a) と言い換えても構わない。

【0225】

次に、レジストマスク 3148 を除去した後、第 1 層間絶縁膜 3151 を形成した。第 1 層間絶縁膜 3151 としては、珪素を含む絶縁膜、具体的には窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜またはそれらを組み合わせた積層膜で形成すれば良い。また、膜厚は $100 \sim 400 \text{ nm}$ とすれば良い。本実施例では、プラズマ CVD 法で SiH_4 、 N_2O 、 NH_3 を原料ガスとし、 200 nm 厚の窒化酸化シリコン膜 (但し窒素濃度が $25 \sim 50 \text{ atomic\%}$) を用いた。

【0226】

その後、それぞれの濃度で添加された n 型または p 型不純物元素を活性化するために熱処理工程を行った。この工程はファーンেসアニール法、レーザーアニール法、またはラピッドサーマルアニール法 (RTA 法) で行うことができる。ここではファーンেসアニール法で活性化工程を行ったが、実施例 1 ないし 3 に示すレーザーアニールを用いても有効である。加熱処理は、窒素雰囲気中において $300 \sim 650^\circ\text{C}$ 、好ましくは $400 \sim 550^\circ\text{C}$ 、ここでは 550°C 、4 時間の熱処理を行った。(図 17 (B))

【0227】

この時、本実施例において非晶質シリコン膜の結晶化に用いた触媒元素 (本実施例ではニッケル) が、矢印で示す方向に移動して、前述の図 16 (F) の工程

で形成された高濃度にリンを含む領域に捕獲（ゲッタリング）された。これはリンによる金属元素のゲッタリング効果に起因する現象であり、この結果、後のチャネル形成領域 3152～3156 は前記触媒元素の濃度が 1×10^{17} atoms/cm³ 以下（好ましくは 1×10^{16} atoms/cm³ 以下）となった。

【0228】

また逆に、触媒元素のゲッタリングサイトとなった領域（図 16（F）の工程で不純物領域 3139～3147 が形成された領域）は高濃度に触媒元素が偏析して 5×10^{18} atoms/cm³ 以上（代表的には 1×10^{19} ～ 5×10^{20} atoms/cm³）濃度で存在するようになった。

【0229】

さらに、3～100%の水素を含む雰囲気中で、300～450℃で1～12時間の熱処理を行い、活性層を水素化する工程を行った。この工程は熱的に励起された水素により半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。水素化の他の手段として、プラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行っても良い。

【0230】

活性化工程を終えたら、第1層間絶縁膜 3151 の上に 500 nm～1.5 μm 厚の第2層間絶縁膜 3157 を形成した。本実施例では第2層間絶縁膜 3157 として 800 nm 厚の酸化シリコン膜をプラズマ CVD 法により形成した。こうして第1層間絶縁膜（窒化酸化シリコン膜）3151 と第2層間絶縁膜（酸化シリコン膜）3157 との積層膜でなる 1 μm 厚の層間絶縁膜を形成した。

【0231】

なお、第2層間絶縁膜 3157 として、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、BCB（ベンゾシクロブテン）等の有機樹脂膜を用いることも可能である。

【0232】

その後、それぞれの TFT のソース領域またはドレイン領域に達するコンタクトホールが形成され、ソース配線 3158～3161 と、ドレイン配線 3162～3165 を形成した。なお、図示されていないが CMOS 回路を形成するため

にドレイン配線 3162、3163 は同一配線として接続されている。また、図示していないが、本実施例ではこの電極を、Ti 膜を 100 nm、Ti を含むアルミニウム膜 300 nm、Ti 膜 150 nm をスパッタ法で連続して形成した 3 層構造の積層膜とした。

【0233】

次に、パッシベーション膜 3166 として、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、または窒化酸化シリコン膜で 50～500 nm（代表的には 200～300 nm）の厚さで形成した。この時、本実施例では膜の形成に先立って H_2 、 NH_3 等水素を含むガスを用いてプラズマ処理を行い、成膜後に熱処理を行った。この前処理により励起された水素が第 1、第 2 層間絶縁膜中に供給される。この状態で熱処理を行うことで、パッシベーション膜 3166 の膜質を改善するとともに、第 1、第 2 層間絶縁膜中に添加された水素が下層側に拡散するため、効果的に活性層を水素化することができた。

【0234】

また、パッシベーション膜 3166 を形成した後に、さらに水素化工程を行っても良い。例えば、3～100%の水素を含む雰囲気中で、300～450℃で 1～12 時間の熱処理を行うと良く、あるいはプラズマ水素化法を用いても同様の効果が得られた。なお、ここで後に画素電極とドレイン配線を接続するためのコンタクトホールを形成する位置において、パッシベーション膜 3166 に開口部を形成しておいても良い。

【0235】

その後、有機樹脂からなる第 3 層間絶縁膜 3167 を約 1 μm の厚さに形成した。有機樹脂としては、ポリイミド、アクリル、ポリアミド、ポリイミドアミド、BCB（ベンゾシクロブテン）等を使用することができる。有機樹脂膜を用いることの利点は、成膜方法が簡単である点や、比誘電率が低いので、寄生容量を低減できる点、平坦性に優れる点などが上げられる。なお上述した以外の有機樹脂膜や有機系 SiO_2 化合物などを用いることもできる。ここでは、基板に塗布後、熱重合するタイプのポリイミドを用い、300℃で焼成して形成した。

【0236】

次に、画素部となる領域において、第 3 層間絶縁膜 3 1 6 7 上に遮蔽膜 3 1 6 8 を形成した。なお、本実施例中では光と電磁波を遮るという意味で遮蔽膜という文言を用いる。

【0 2 3 7】

遮蔽膜 3 1 6 8 はアルミニウム (A l)、チタン (T i)、タンタル (T a) から選ばれた元素でなる膜またはいずれかの元素を主成分とする膜で 1 0 0 ~ 3 0 0 n m の厚さに形成した。本実施例では 1 w t % のチタンを含有させたアルミニウム膜を 1 2 5 n m の厚さに形成した。

【0 2 3 8】

なお、第 3 層間絶縁膜 3 1 6 7 上に酸化シリコン膜等の絶縁膜を 5 ~ 5 0 n m 形成しておく、この上に形成する遮蔽膜の密着性を高めることができた。また、有機樹脂で形成した第 3 層間絶縁膜 3 1 6 7 の表面に C F₄ ガスを用いたプラズマ処理を施すと、表面改質により膜上に形成する遮蔽膜の密着性を向上させることができた。

【0 2 3 9】

また、このチタンを含有させたアルミニウム膜を用いて、遮蔽膜だけでなく他の接続配線を形成することも可能である。例えば、駆動回路内で回路間をつなぐ接続配線を形成できる。但し、その場合は遮蔽膜または接続配線を形成する材料を成膜する前に、予め第 3 層間絶縁膜にコンタクトホールを形成しておく必要がある。

【0 2 4 0】

次に、遮蔽膜 3 1 6 8 の表面に陽極酸化法またはプラズマ酸化法（本実施例では陽極酸化法）により 2 0 ~ 1 0 0 n m （好ましくは 3 0 ~ 5 0 n m）の厚さの酸化物 3 1 6 9 を形成した。本実施例では遮蔽膜 3 1 6 8 としてアルミニウムを主成分とする膜を用いたため、陽極酸化物 3 1 6 9 として酸化アルミニウム膜（アルミナ膜）が形成された。

【0 2 4 1】

この陽極酸化処理に際して、まず十分にアルカリイオン濃度の小さい酒石酸エチレングリコール溶液を作製した。これは 1 5 % の酒石酸アンモニウム水溶液と

エチレングリコールとを 2 : 8 で混合した溶液であり、これにアンモニア水を加え、pH が 7 ± 0.5 となるように調節した。そして、この溶液中に陰極となる白金電極を設け、遮蔽膜 3164 が形成されている基板を溶液に浸し、遮蔽膜 3168 を陽極として、一定（数 mA ～ 数十 mA）の直流電流を流した。

【0242】

溶液中の陰極と陽極との間の電圧は陽極酸化物の成長に従い時間と共に変化するが、定電流のまま 100 V/min の昇圧レートで電圧を上昇させて、到達電圧 45 V に達したところで陽極酸化処理を終了させた。このようにして遮蔽膜 3168 の表面には厚さ約 50 nm の陽極酸化物 3169 を形成することができた。また、その結果、遮蔽膜 3168 の膜厚は 90 nm となった。なお、ここで示した陽極酸化法に係わる数値は一例にすぎず、作製する素子の大きさ等によって当然最適値は変化するものである。

【0243】

また、ここでは陽極酸化法を用いて遮蔽膜表面のみに絶縁膜を設ける構成としたが、絶縁膜をプラズマ CVD 法、熱 CVD 法またはスパッタ法などの気相法によって形成しても良い。その場合も膜厚は $20 \sim 100 \text{ nm}$ （好ましくは $30 \sim 50 \text{ nm}$ ）とすることが好ましい。また、酸化シリコン膜、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜、DLC (Diamond like carbon) 膜または有機樹脂膜を用いても良い。さらに、これらを組み合わせた積層膜を用いても良い。

【0244】

次に、第 3 層間絶縁膜 3167、パッシベーション膜 3166 にドレイン配線 3165 に達するコンタクトホールを形成し、画素電極 3170 を形成した。なお、画素電極 3171、3172 はそれぞれ隣接する別の画素の画素電極である。画素電極 3170 ～ 3172 は、透過型液晶表示装置とする場合には透明導電膜を用い、反射型の液晶表示装置とする場合には金属膜を用いれば良い。ここでは透過型の液晶表示装置とするために、酸化インジウム・スズ (ITO) 膜を 10 nm の厚さにスパッタ法で形成した。

【0245】

また、この時、画素電極 3170 と遮蔽膜 3168 とが陽極酸化物 3169 を

介して重なり、保持容量（キャパシタンス・ストレージ）3 1 7 3を形成した。なお、この場合、遮蔽膜3 1 6 8をフローティング状態（電氣的に孤立した状態）か固定電位、好ましくはコモン電位（データとして送られる画像信号の中間電位）に設定しておくことが望ましい。

【0 2 4 6】

こうして同一基板上に、駆動回路と画素部とを有したアクティブマトリクス基板が完成した。なお、図1 7（C）においては、駆動回路にはpチャネル型TF T 3 3 0 1、nチャネル型TF T 3 3 0 2、3 3 0 3が形成され、画素部にはnチャネル型TF Tでなる画素TF T 3 3 0 4が形成された。

【0 2 4 7】

駆動回路のpチャネル型TF T 3 3 0 1には、チャネル形成領域3 2 0 1、ソース領域3 2 0 2、ドレイン領域3 2 0 3がそれぞれp型不純物領域（a）で形成された。但し、実際にはソース領域またはドレイン領域の一部に $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度でリンを含む領域が存在する。また、その領域には図1 7（B）の工程でゲッタリングされた触媒元素が $5 \times 10^{18} \text{ atoms/cm}^3$ 以上（代表的には $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{20} \text{ atoms/cm}^3$ ）濃度で存在する。

【0 2 4 8】

また、nチャネル型TF T 3 3 0 2には、チャネル形成領域3 2 0 4、ソース領域3 2 0 5、ドレイン領域3 2 0 6、そしてチャネル形成領域の片側（ドレイン領域側）に、ゲート絶縁膜を介してゲート配線と重なった領域（本実施例中ではこのような領域をLov領域という。なお、ovはoverlapの意味で付した。）3 2 0 7が形成された。この時、Lov領域3 2 0 7は $2 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度でリンを含み、且つ、ゲート配線と全部重なるように形成された。

【0 2 4 9】

また、nチャネル型TF T 2 3 0 3には、チャネル形成領域2 2 0 8、ソース領域2 2 0 9、ドレイン領域2 2 1 0、そしてチャネル形成領域の両側にLDD領域2 2 1 1、2 2 1 2が形成された。なお、この構造ではLDD領域2 2 1 1、2 2 1 2の一部がゲート配線と重なるように配置されたために、ゲート絶縁膜を介してゲート配線と重なった領域（Lov領域）とゲート配線と重ならない領域

(本実施例中ではこのような領域をL off領域という。なお、ffはoffsetの意味で付した。) が実現されている。

【0 2 5 0】

ここで図 1 9 に示す断面図は図 1 7 (C) に示した n チャンネル型 T F T 3 3 0 3 を図 1 7 (B) の工程まで作製した状態を示す拡大図である。ここに示すように、L D D 領域 3 2 1 1 はさらに L o v 領域 3 2 1 1 a、L o f f 領域 3 2 1 1 b に区別できる。また、前述の L o v 領域 3 2 1 1 a には $2 \times 10^{16} \sim 5 \times 10^{19} \text{ atoms/cm}^3$ の濃度でリンが含まれるが、L o f f 領域 3 2 1 1 b はその 1 ~ 2 倍 (代表的には 1. 2 ~ 1. 5 倍) の濃度でリンが含まれる。

【0 2 5 1】

また、画素 T F T 3 3 0 4 には、チャンネル形成領域 3 2 1 3、3 2 1 4、ソース領域 3 2 1 5、ドレイン領域 3 2 1 6、L o f f 領域 3 2 1 7 ~ 3 2 2 0、L o f f 領域 3 2 1 8、3 2 1 9 に接した n 型不純物領域 (a) 3 2 2 1 が形成された。この時、ソース領域 3 2 1 5、ドレイン領域 3 2 1 6 はそれぞれ n 型不純物領域 (a) で形成され、L o f f 領域 3 2 1 7 ~ 3 2 2 0 は n 型不純物領域 (c) で形成された。

【0 2 5 2】

本実施例では、画素部および駆動回路が要求する回路仕様に応じて各回路を形成する T F T の構造を最適化し、半導体装置の動作性能および信頼性を向上させることができた。具体的には、n チャンネル型 T F T は回路仕様に応じて L D D 領域の配置を異ならせ、L o v 領域または L o f f 領域を使い分けることによって、同一基板上に高速動作またはホットキャリア対策を重視した T F T 構造と低オフ電流動作を重視した T F T 構造とを実現した。

【0 2 5 3】

例えば、アクティブマトリクス型液晶表示装置の場合、n チャンネル型 T F T 3 3 0 2 は高速動作を重視するシフトレジスタ回路、分周波回路、信号分割回路、レベルシフタ回路、バッファ回路などの駆動回路に適している。即ち、チャンネル形成領域の片側 (ドレイン領域側) のみに L o v 領域を配置することで、できるだけ抵抗成分を低減させつつホットキャリア対策を重視した構造となっている。こ

れは上記回路群の場合、ソース領域とドレイン領域の機能が変わらず、キャリア（電子）の移動する方向が一定だからである。但し、必要に応じてチャンネル形成領域の両側に Lov 領域を配置することもできる。

【0 2 5 4】

また、n チャンネル型 T F T 3 3 0 3 はホットキャリア対策と低オフ電流動作の双方を重視するサンプリング回路（サンプルホールド回路）に適している。即ち、Lov 領域を配置することでホットキャリア対策とし、さらに L off 領域を配置することで低オフ電流動作を実現した。また、サンプリング回路はソース領域とドレイン領域の機能が反転してキャリアの移動方向が 180° 変わるため、ゲート配線を中心に線対称となるような構造としなければならない。なお、場合によっては Lov 領域のみとすることもありうる。

【0 2 5 5】

また、n チャンネル型 T F T 3 3 0 4 は低オフ電流動作を重視した画素部、サンプリング回路（サンプルホールド回路）に適している。即ち、オフ電流値を増加させる要因となりうる Lov 領域を配置せず、L off 領域のみを配置することで低オフ電流動作を実現している。また、駆動回路の L D D 領域よりも低い濃度の L D D 領域を L off 領域として用いることで、多少オン電流値が低下しても徹底的にオフ電流値を低減する対策を打っている。さらに、n 型不純物領域 (a) 3 2 2 1 はオフ電流値を低減する上で非常に有効であることが確認されている。

【0 2 5 6】

また、チャンネル長 $3 \sim 7 \mu\text{m}$ に対して n チャンネル型 T F T 3 3 0 2 の Lov 領域 3 2 0 7 の長さ（幅）は $0.5 \sim 3.0 \mu\text{m}$ 、代表的には $1.0 \sim 1.5 \mu\text{m}$ とすれば良い。また、n チャンネル型 T F T 2 3 0 3 の Lov 領域 3 2 1 1 a、3 2 1 2 a の長さ（幅）は $0.5 \sim 3.0 \mu\text{m}$ 、代表的には $1.0 \sim 1.5 \mu\text{m}$ 、L off 領域 3 2 1 1 b、3 2 1 2 b の長さ（幅）は $1.0 \sim 3.5 \mu\text{m}$ 、代表的には $1.5 \sim 2.0 \mu\text{m}$ とすれば良い。また、画素 T F T 3 3 0 4 に設けられる L off 領域 3 2 1 7 \sim 3 2 2 0 の長さ（幅）は $0.5 \sim 3.5 \mu\text{m}$ 、代表的には $2.0 \sim 2.5 \mu\text{m}$ とすれば良い。

【0 2 5 7】

さらに、pチャネル型TFT3301は自己整合（セルフアライン）的に形成され、nチャネル型TFT3302～3304は非自己整合（ノンセルフアライン）的に形成されている点も本発明の特徴の一つである。

【0258】

また、本実施例では保持容量の誘電体として比誘電率が7～9と高いアルミナ膜を用いたことで、必要な容量を形成するための面積を少なくすることを可能とした。さらに、本実施例のように画素TFT上に形成される遮蔽膜を保持容量の一方の電極とすることで、アクティブマトリクス型液晶表示装置の画像表示部の開口率を向上させることができた。

【0259】

なお、本発明は本実施例に示した保持容量の構造に限定される必要はない。例えば、本出願人による特願平9-316567号出願や特願平10-254097号出願に記載された保持容量の構造を用いることもできる。

【0260】

図18に示すように、図17（C）の状態の基板に対し、配向膜3401を形成した。本実施例では配向膜としてポリイミド膜を用いた。また、対向基板3402には、透明導電膜3403と、配向膜3404とを形成した。なお、対向基板には必要に応じてカラーフィルターや遮蔽膜を形成しても良い。

【0261】

次に、配向膜を形成した後、ラビング処理を施して液晶分子がある一定のプレチルト角を持って配向するようにした。そして、画素部と、駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とを、公知のセル組み工程によってシール材やスペーサ（共に図示せず）などを介して貼りあわせた。その後、両基板の間に液晶3405を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止した。液晶には公知の液晶材料を用いれば良い。このようにして図18に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成した。

【0262】

次に、このアクティブマトリクス型液晶表示装置の構成を、図20の斜視図を用いて説明する。尚、図20は、図15～図17の断面構造図と対応付けるため

、共通の符号を用いている。アクティブマトリクス基板は、ガラス基板 3101 上に形成)れた、画素部 3601 と、走査(ゲート)信号駆動回路 3602 と、画像(ソース)信号駆動回路 3603 で構成される。画素部の画素 TFT 3304 は n チャンネル型 TFT であり、周辺に設けられる駆動回路は CMOS 回路を基本として構成されている。走査信号駆動回路 3602 と、画像信号駆動回路 3603 はそれぞれゲート配線 3124 とソース配線 3152 で画素部 3601 に接続されている。また、FPC 3604 が接続された外部入出力端子 3605 から駆動回路の入出力端子までの接続配線 3606、3607 が設けられている。

【0263】

〔実施例 7〕

本願発明を実施して形成された CMOS 回路や画素マトリクス回路は様々な電気光学装置(アクティブマトリクス型液晶ディスプレイ、アクティブマトリクス型 EL ディスプレイ、アクティブマトリクス型 EC ディスプレイ)に用いることができる。即ち、それら電気光学装置を表示媒体として組み込んだ電子機器全てに本願発明を実施できる。

【0264】

その様な電子機器としては、ビデオカメラ、デジタルカメラ、プロジェクター(リア型またはフロント型)、ヘッドマウントディスプレイ(ゴーグル型ディスプレイ)、カーナビゲーション、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等)などが挙げられる。それらの一例を図 23 及び図 24 に示す。

【0265】

図 23 (A) はパーソナルコンピュータであり、本体 2001、画像入力部 2002、表示装置 2003、キーボード 2004 で構成される。本願発明を画像入力部 2002、表示装置 2003 やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0266】

図 23 (B) はビデオカメラであり、本体 2101、表示装置 2102、音声入力部 2103、操作スイッチ 2104、バッテリー 2105、受像部 2106

で構成される。本願発明を表示装置 2 1 0 2、音声入力部 2 1 0 3 やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0 2 6 7】

図 2 3 (C) はモバイルコンピュータ (モービルコンピュータ) であり、本体 2 2 0 1、カメラ部 2 2 0 2、受像部 2 2 0 3、操作スイッチ 2 2 0 4、表示装置 2 2 0 5 で構成される。本願発明は表示装置 2 2 0 5 やその他の信号制御回路に適用できる。

【0 2 6 8】

図 2 3 (D) はゴーグル型ディスプレイであり、本体 2 3 0 1、表示装置 2 3 0 2、アーム部 2 3 0 3 で構成される。本発明は表示装置 2 3 0 2 やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0 2 6 9】

図 2 3 (E) はプログラムを記録した記録媒体 (以下、記録媒体と呼ぶ) を用いるプレーヤーであり、本体 2 4 0 1、表示装置 2 4 0 2、スピーカ部 2 4 0 3、記録媒体 2 4 0 4、操作スイッチ 2 4 0 5 で構成される。なお、この装置は記録媒体として DVD (Digital Versatile Disc)、CD 等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行うことができる。本発明は表示装置 2 4 0 2 やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0 2 7 0】

図 2 3 (F) はデジタルカメラであり、本体 2 5 0 1、表示装置 2 5 0 2、接眼部 2 5 0 3、操作スイッチ 2 5 0 4、受像部 (図示しない) で構成される。本願発明を表示装置 2 5 0 2 やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0 2 7 1】

図 2 4 (A) はフロント型プロジェクターであり、表示装置 2 6 0 1、スクリーン 2 6 0 2 で構成される。本発明は表示装置やその他の信号制御回路に適用することができる。

【0 2 7 2】

図 2 4 (B) はリア型プロジェクターであり、本体 2 7 0 1、表示装置 2 7 0 2、ミラー 2 7 0 3、スクリーン 2 7 0 4 で構成される。本発明は表示装置やそ

の他の信号制御回路に適用することができる。

【0273】

なお、図24（C）は、図24（A）及び図24（B）中における表示装置2601、2702の構造の一例を示した図である。表示装置2601、2702は、光源光学系2801、ミラー2802、2804～2806、ダイクロイックミラー2803、プリズム2807、液晶表示装置2808、位相差板2809、投射光学系2810で構成される。投射光学系2810は、投射レンズを含む光学系で構成される。本実施例は三板式の例を示したが、特に限定されず、例えば単板式であってもよい。また、図24（C）中において矢印で示した光路に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差を調節するためのフィルム、IRフィルム等の光学系を設けてもよい。

【0274】

また、図24（D）は、図24（C）中における光源光学系2801の構造の一例を示した図である。本実施例では、光源光学系2801は、リフレクター2811、光源2812、2813、2814、偏光変換素子2815、集光レンズ2816で構成される。なお、図24（D）に示した光源光学系は一例であって特に限定されない。例えば、光源光学系に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差を調節するフィルム、IRフィルム等の光学系を設けてもよい。

【0275】

以上の様に、本願発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例1～7のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。

【0276】

【発明の効果】

本発明により、被処理基板全面に均一なレーザーアニールを施すことが可能となった。その結果、基板面内における半導体装置の特性を均一にすることができた。また、被形成面でのレーザービームの面積を広くすることができ、生産性を向上することができた。

【 0 2 7 7 】

そして、本発明を利用して作製された T F T を使って、例えば、アクティブマトリクス型液晶表示装置を作製した場合、従来と比較してレーザーの加工あとが目立たないものができた。

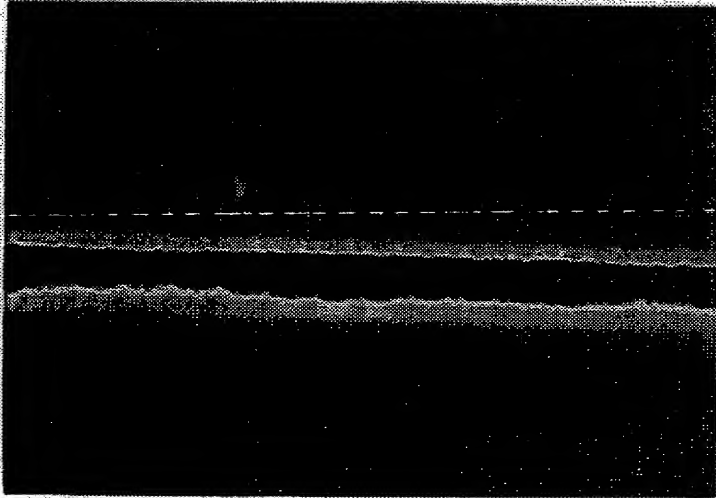
【図面の簡単な説明】

- 【図 1】 従来の線状レーザービームを照射された珪素膜の写真。
- 【図 2】 図 1 を模式的に示した図。
- 【図 3】 従来における線状レーザービームを形成する光学系と光路図。
- 【図 4】 従来の分割する光学系に入射するレーザービームを示す図。
- 【図 5】 従来における線状レーザービームを形成する光学系と光路図。
- 【図 6】 本発明における線状レーザービームを形成する光学系と光路図。
- 【図 7】 本発明における線状レーザービームを形成する光学系と光路図。
- 【図 8】 レーザー照射装置の概略図。
- 【図 9】 線状レーザービームのエネルギー分布の幅方向の断面図。
- 【図 1 0】 本発明の線状レーザービームを照射された珪素膜の写真。
- 【図 1 1】 図 1 0 を模式的に示した図。
- 【図 1 2】 本発明におけるレーザー照射システムを示す図。
- 【図 1 3】 本発明における線状レーザーを形成する光学系と光路図。
- 【図 1 4】 正形状のレーザービームに加工する光学系と光路図。
- 【図 1 5】 画素回路と制御回路の作製工程を示す図。
- 【図 1 6】 画素回路と制御回路の作製工程を示す図。
- 【図 1 7】 画素回路と制御回路の作製工程を示す図。
- 【図 1 8】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の断面構造図。
- 【図 1 9】 n チャネル型 T F T の L D D 構造を示す図。
- 【図 2 0】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の斜視図。
- 【図 2 1】 反射ミラーを設けない光学系を示す図
- 【図 2 2】 反射ミラーの搬入位置を変えた光学系を示す図
- 【図 2 3】 電子機器への応用例を示す図。
- 【図 2 4】 プロジェクターへの応用例を示す図。

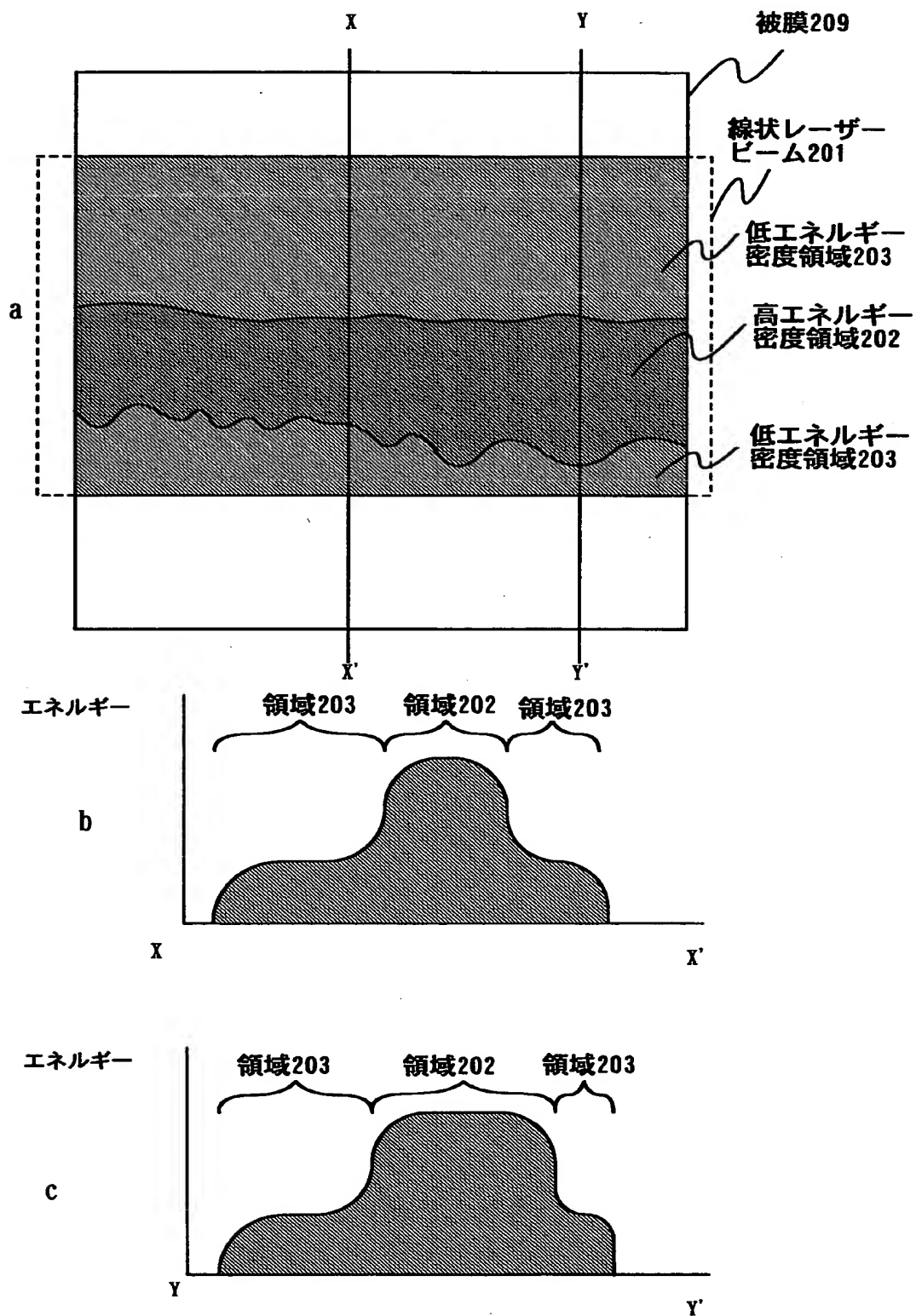
特平 1 1 - 1 4 4 0 6 4

【書類名】 図面

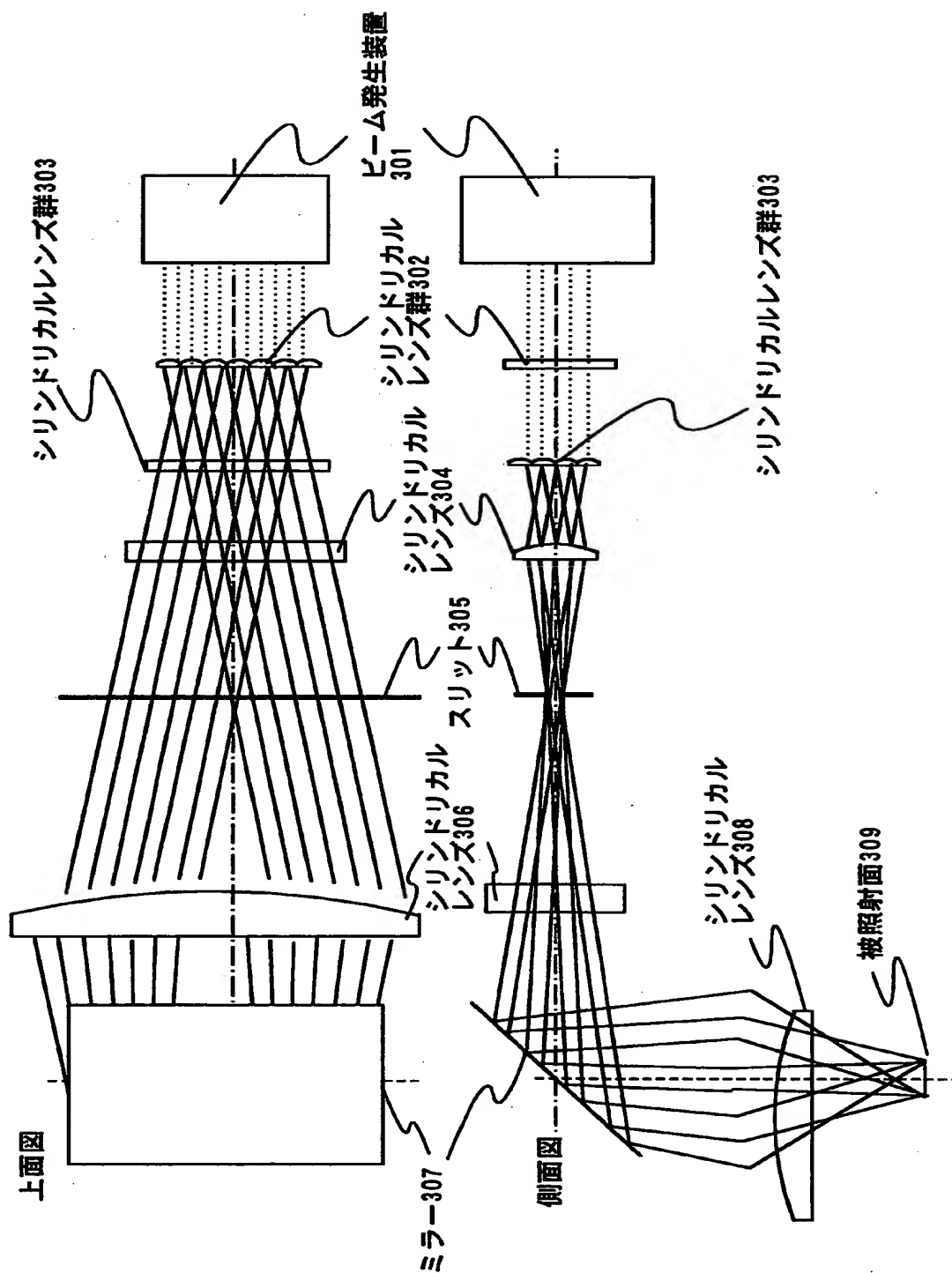
【図 1】



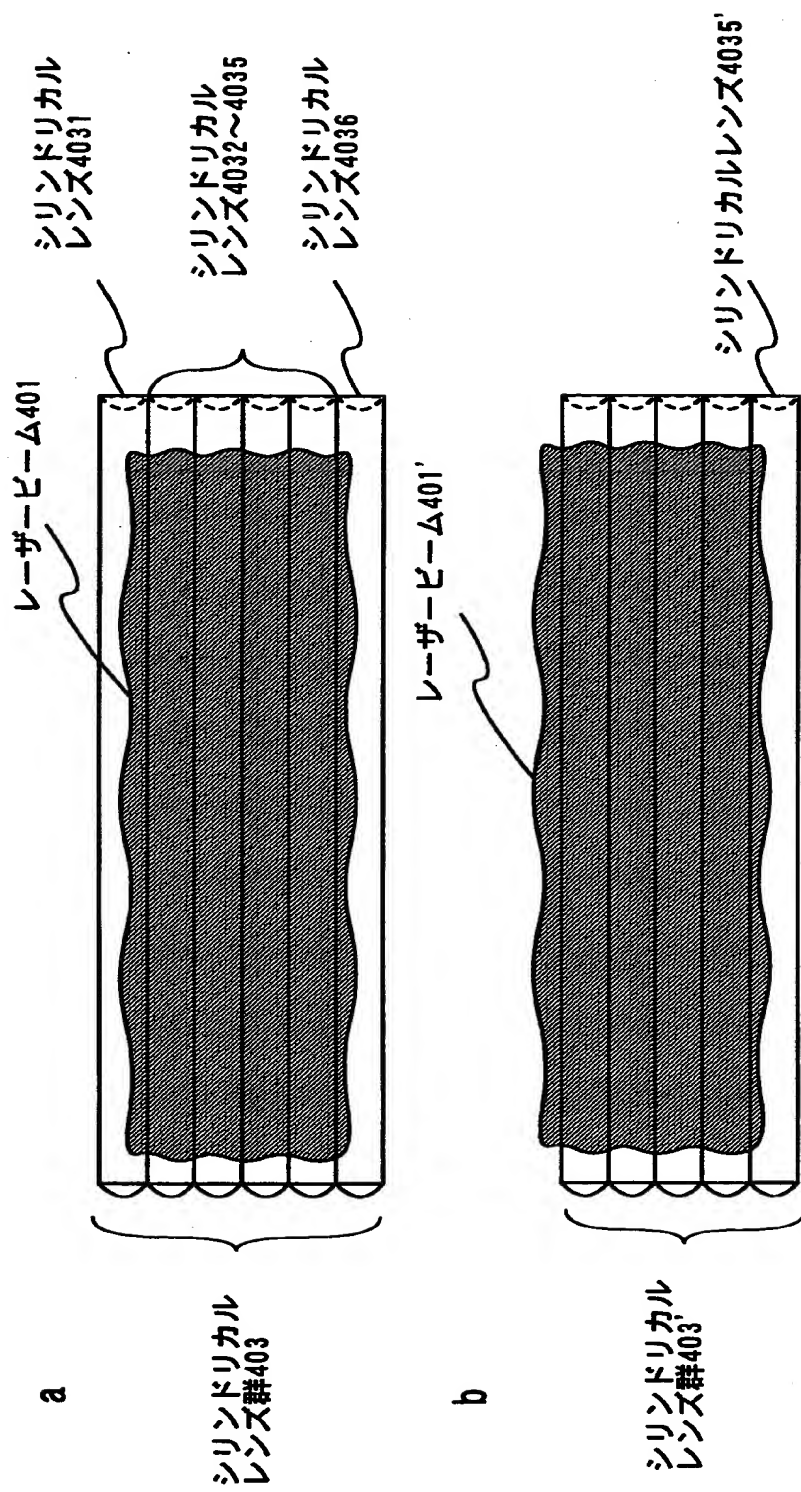
【図 2】



【図 3】

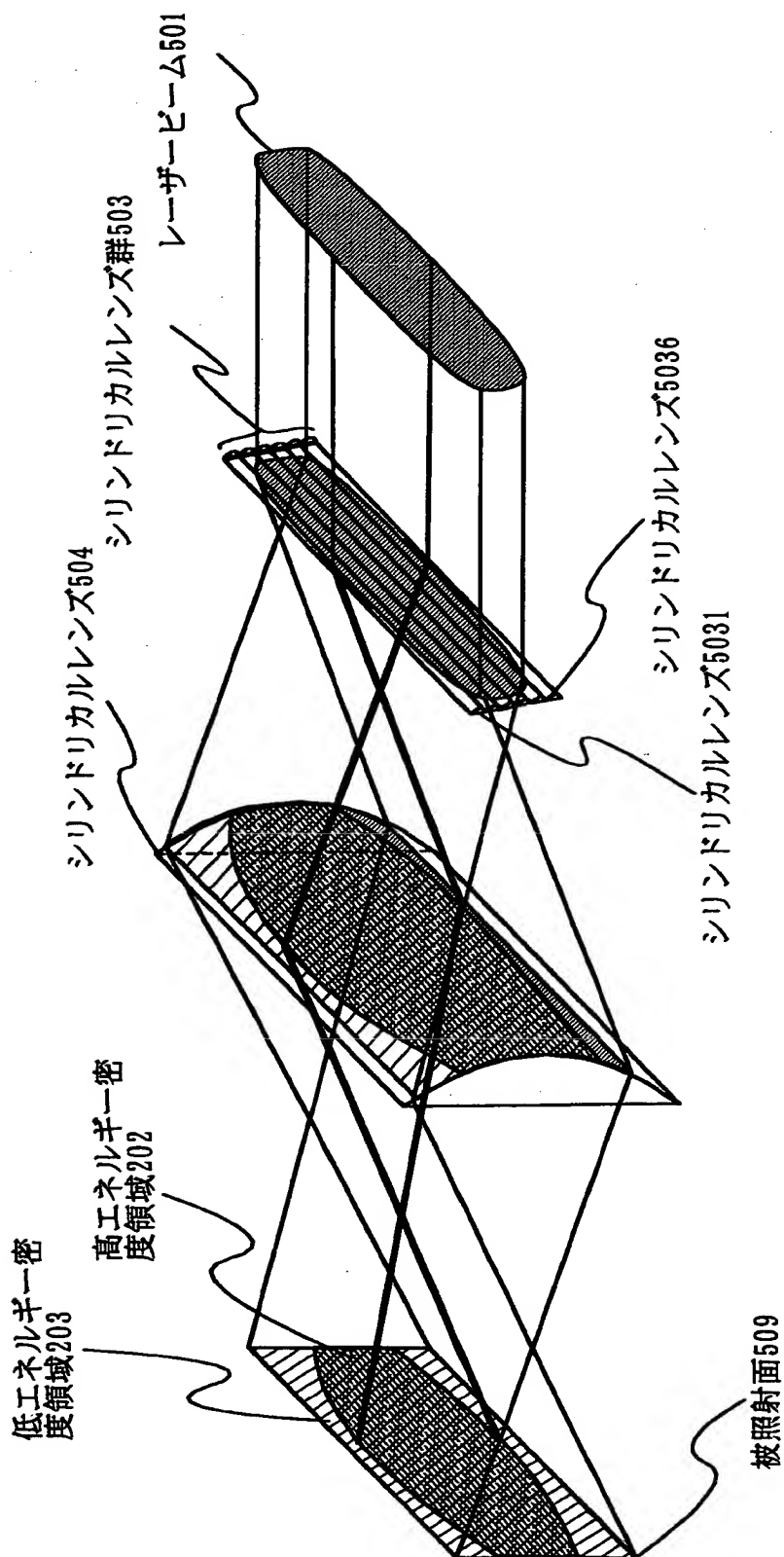


【図 4】



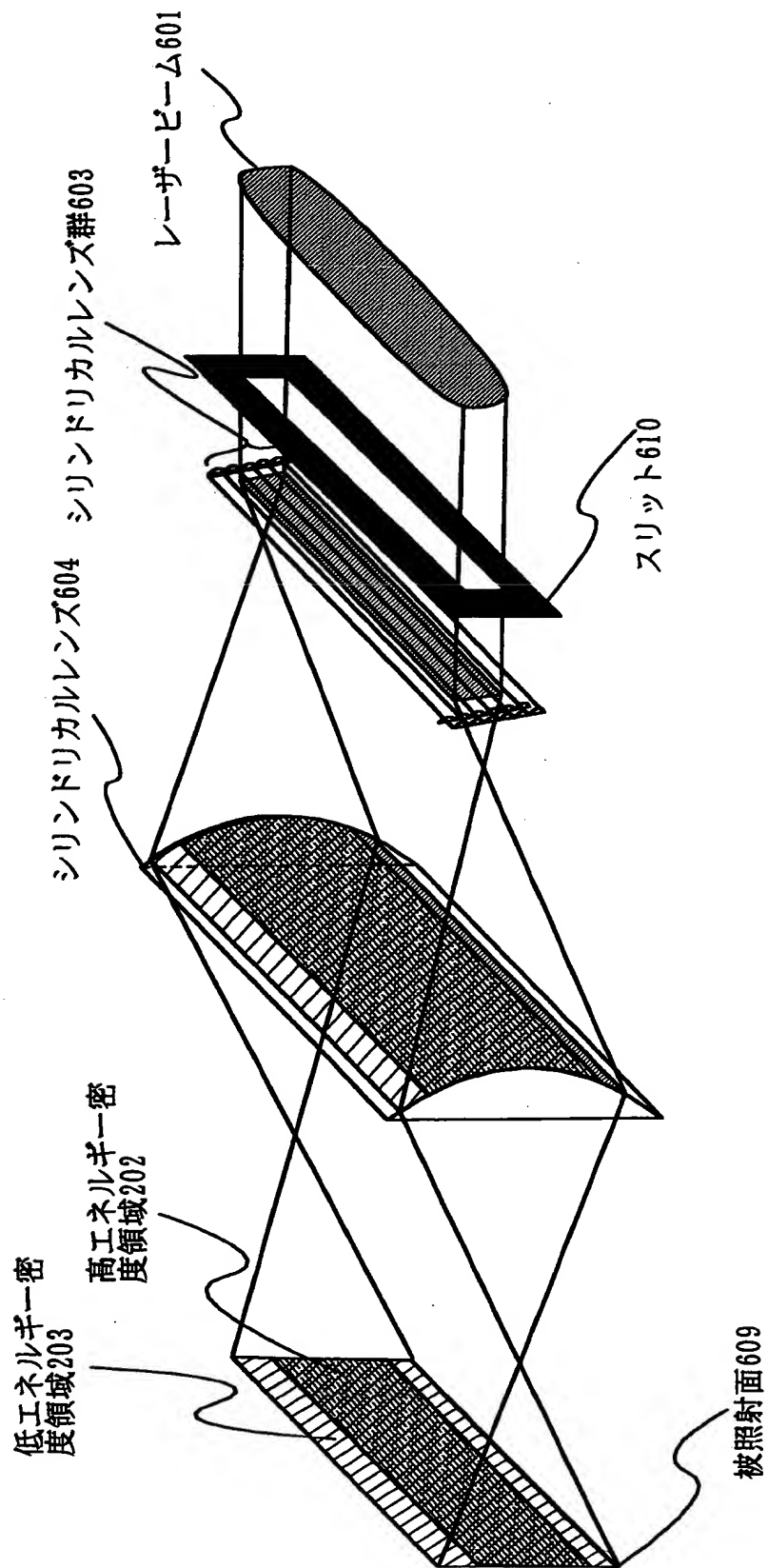
特平 1 1 - 1 4 4 0 6 4

【図 5】



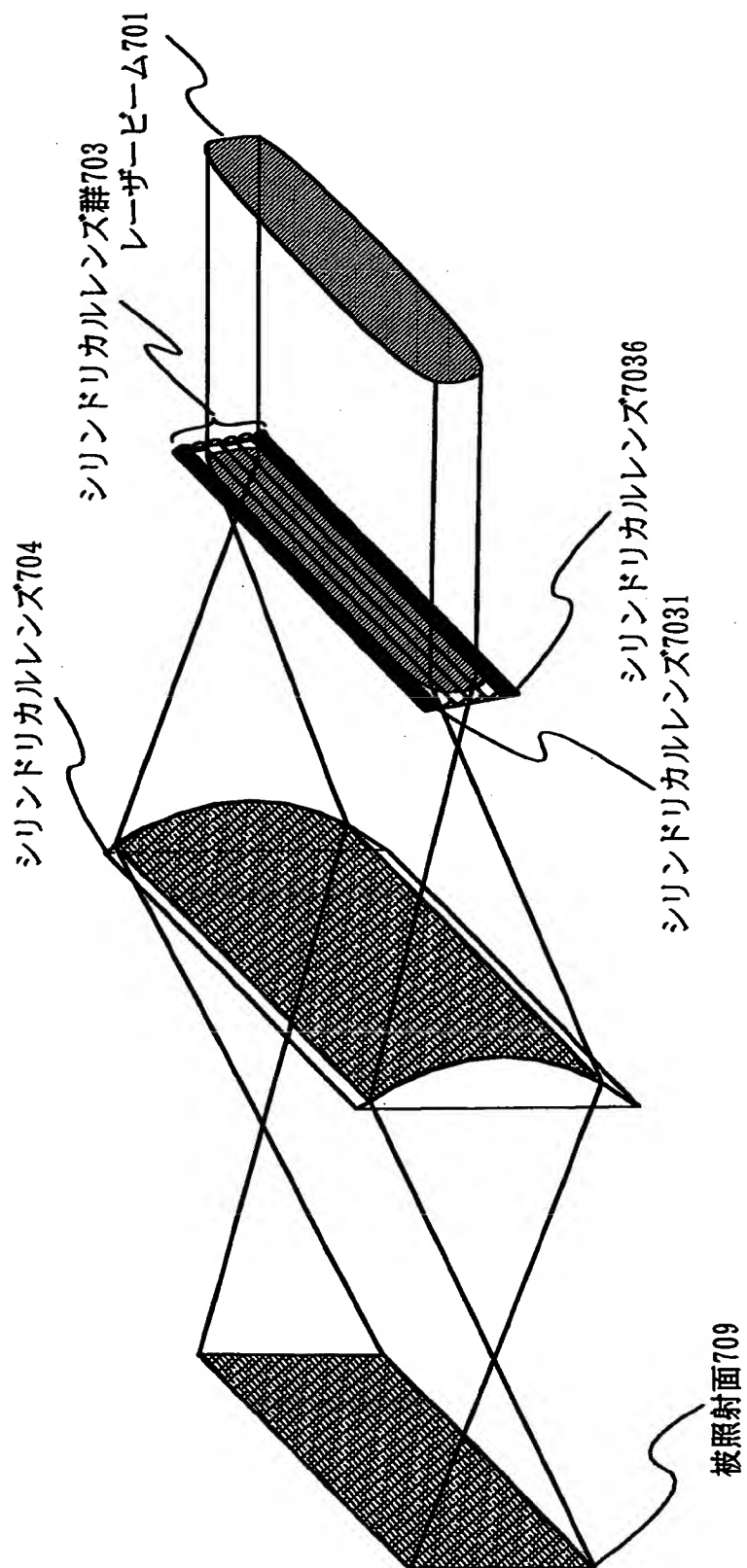
特平 1 1 - 1 4 4 0 6 4

【図 6】



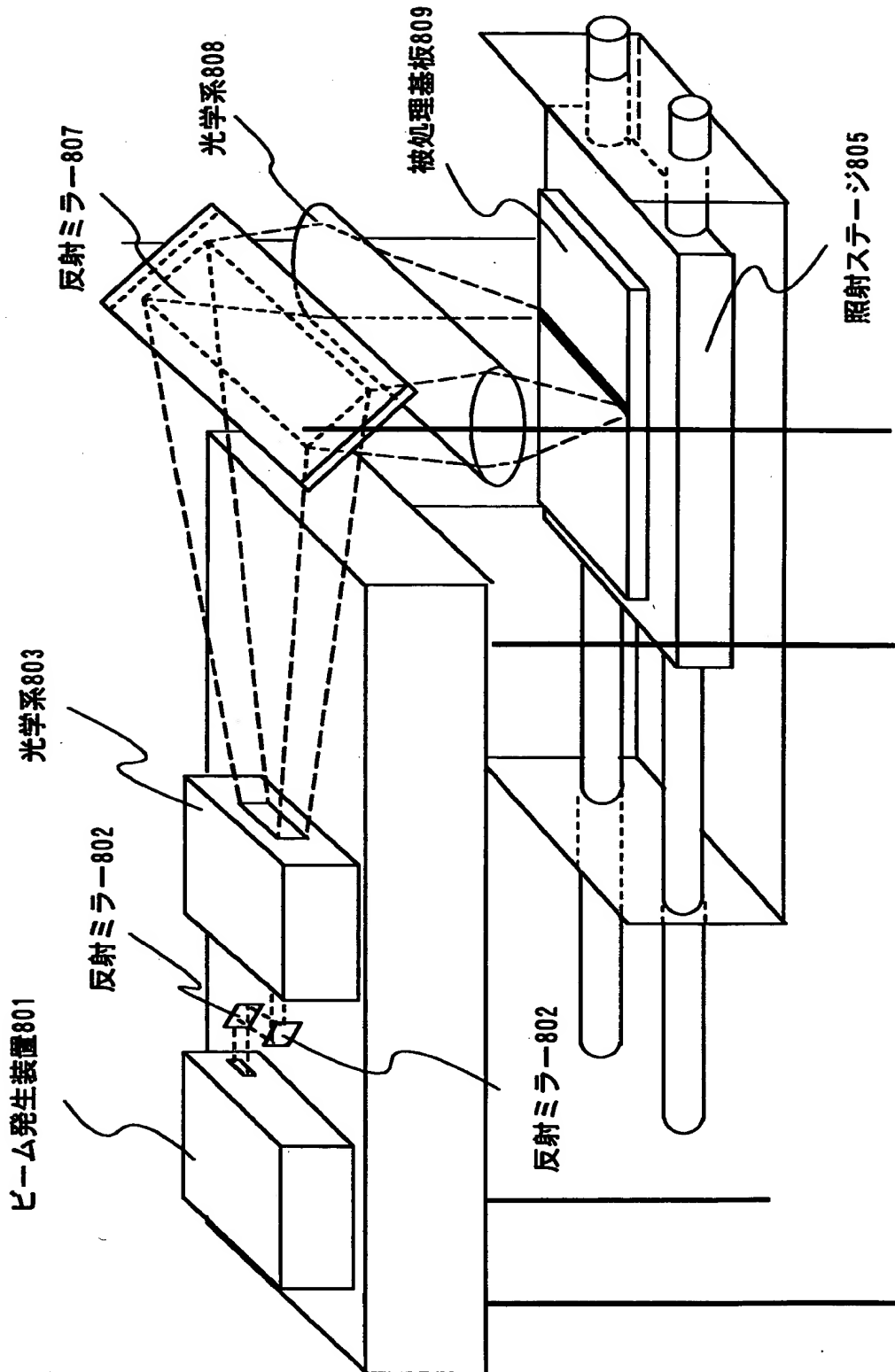
特平 1 1 - 1 4 4 0 6 4

【図 7】

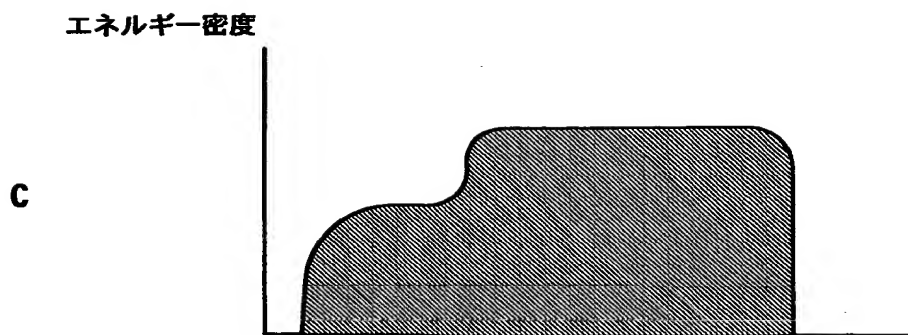
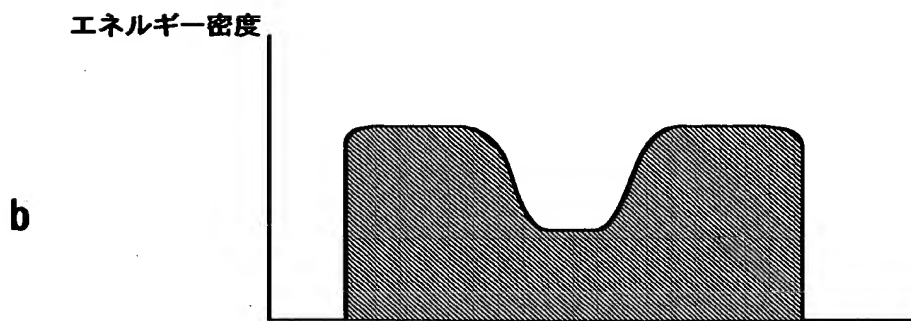
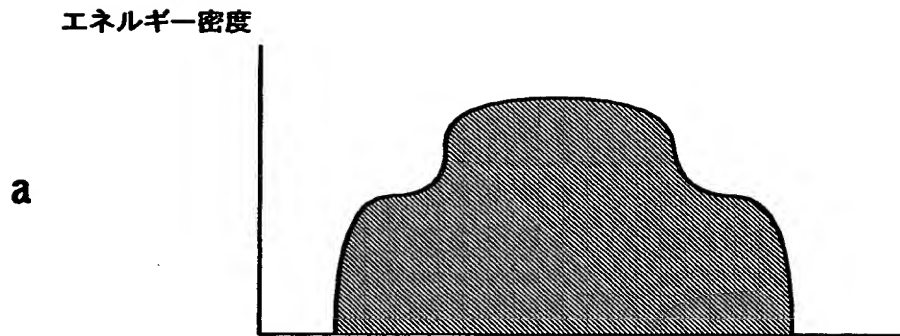


特平 1 1 - 1 4 4 0 6 4

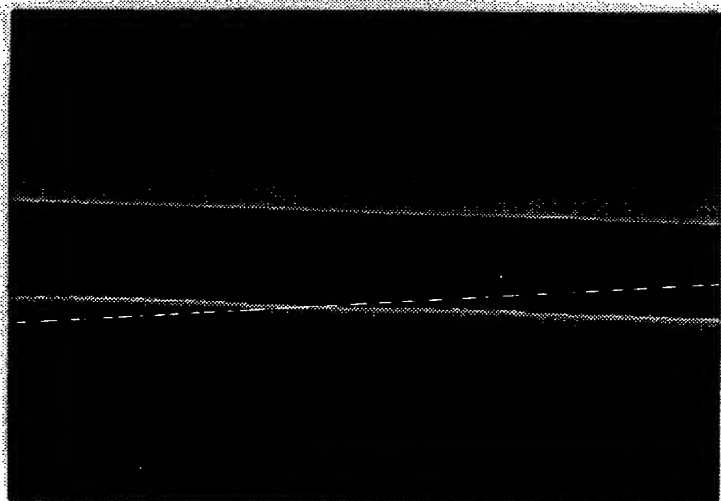
【図 8】



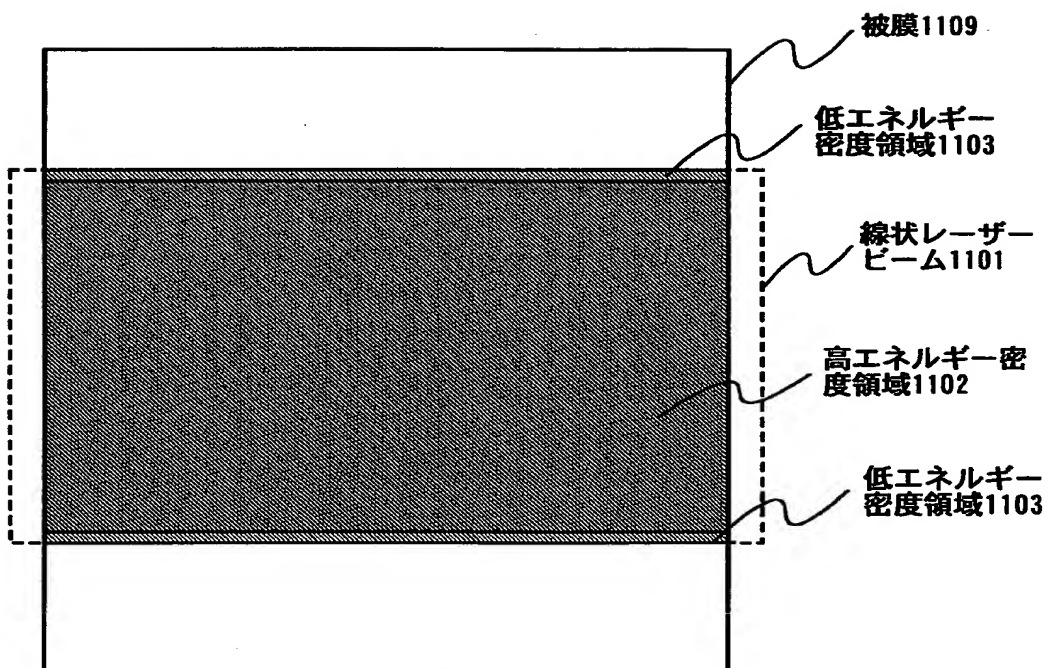
【図 9】



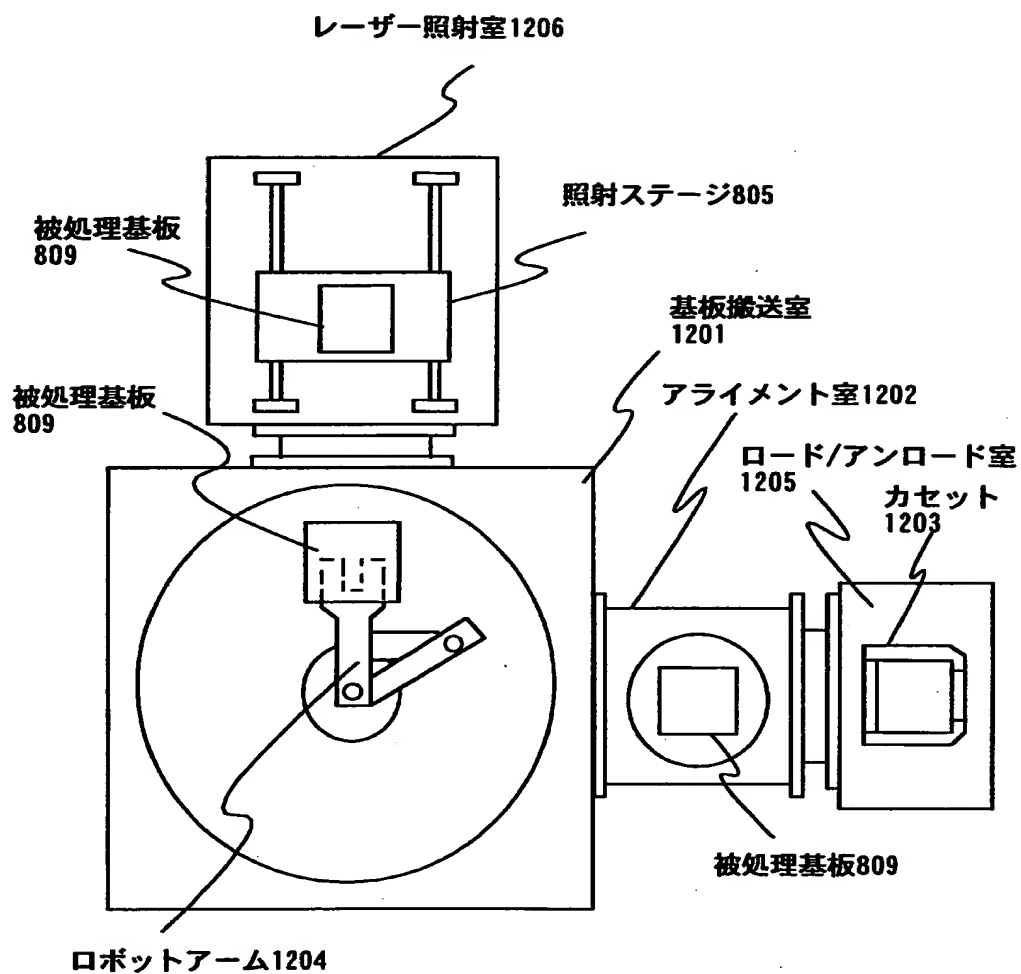
【図 1 0】



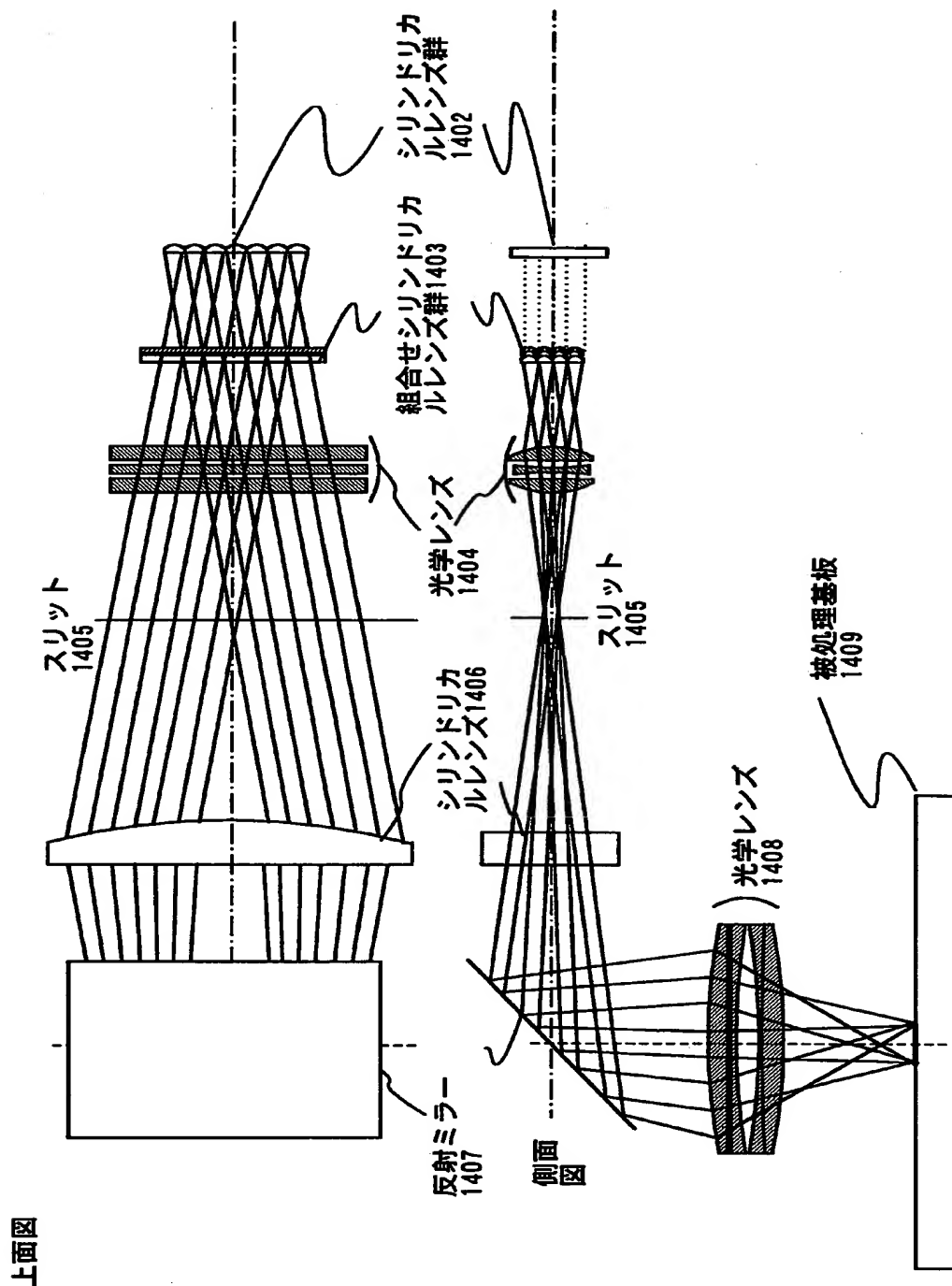
【図 1 1】



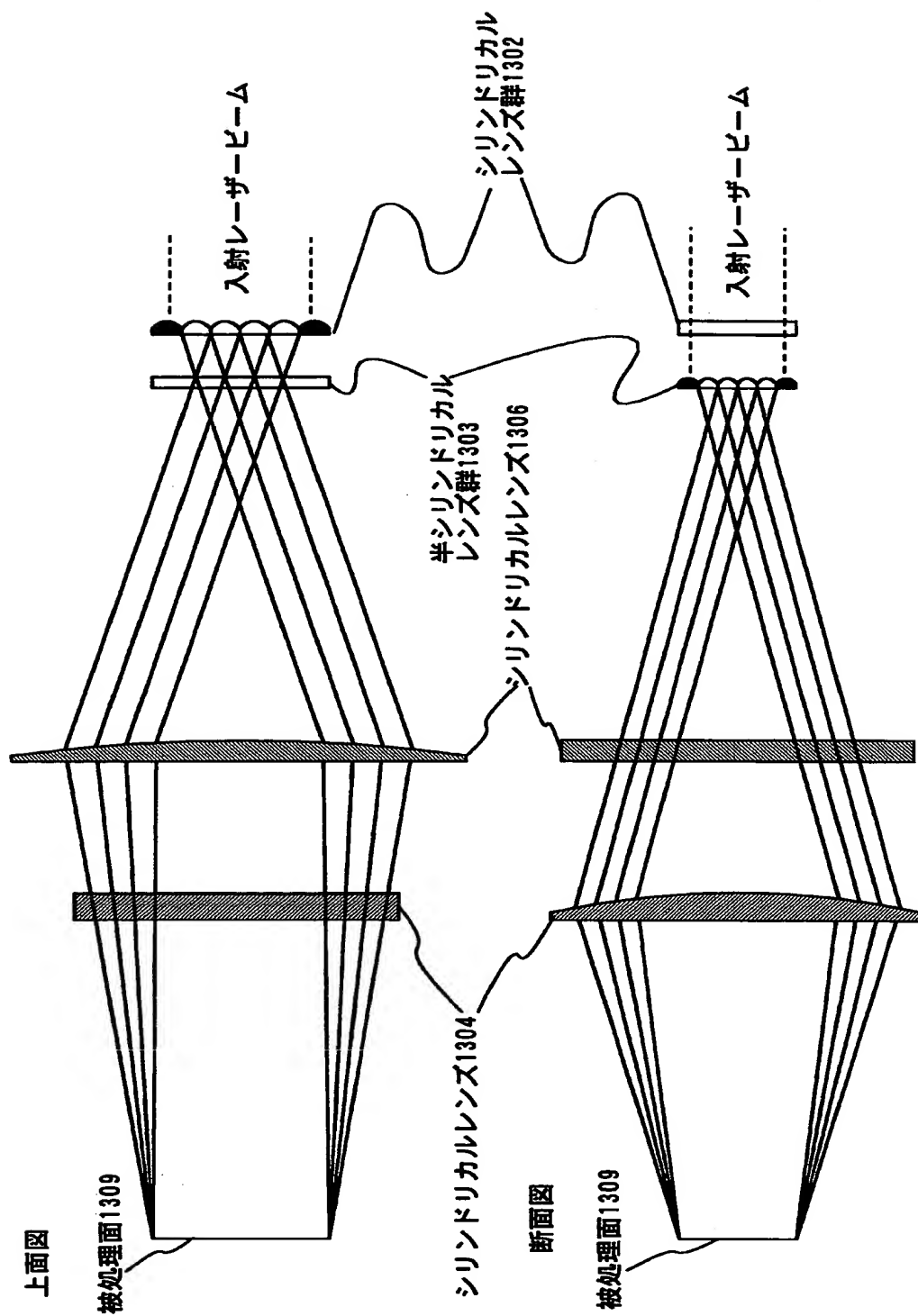
【図 12】



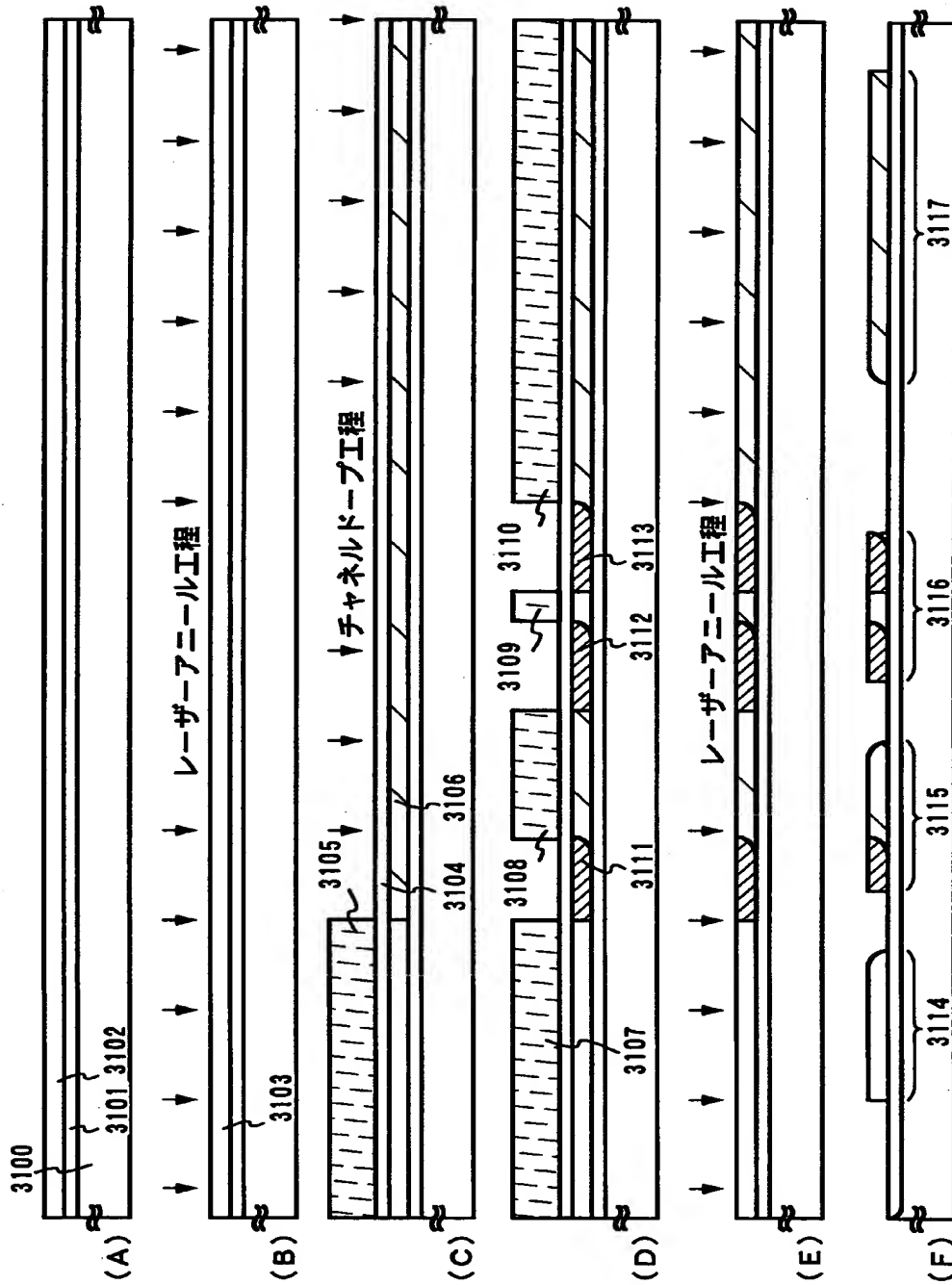
【図 13】



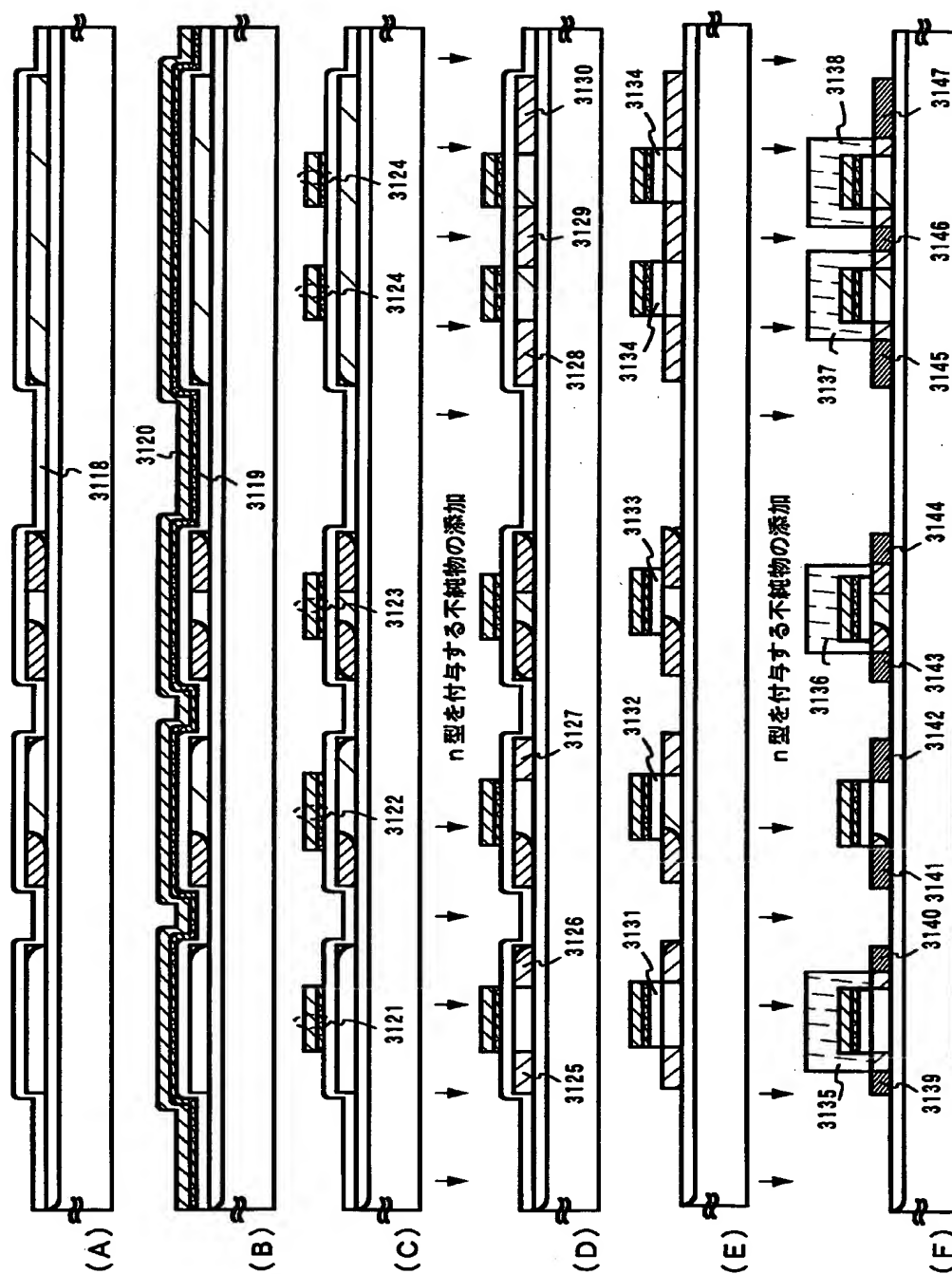
【図 1 4】



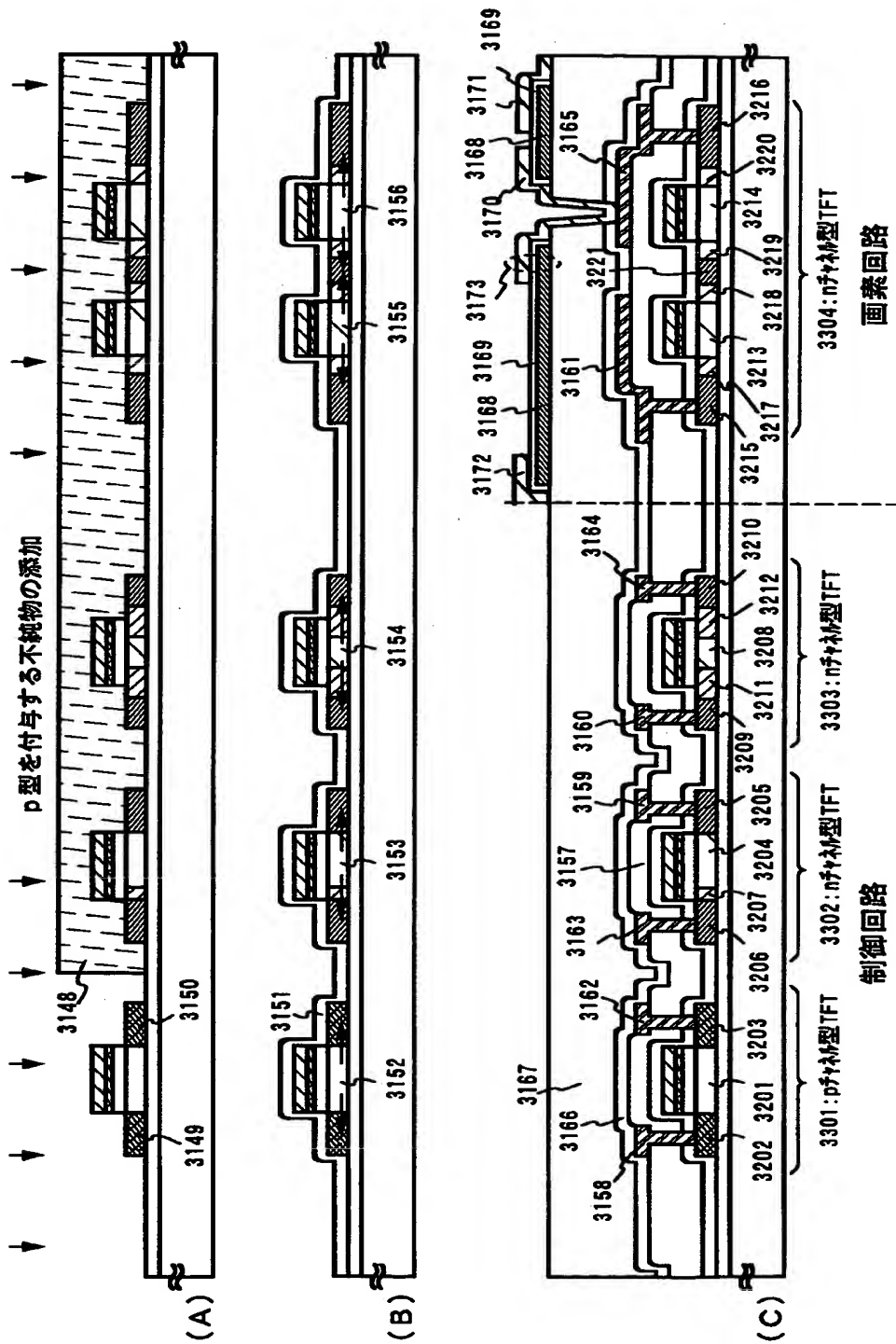
【図 1 5】



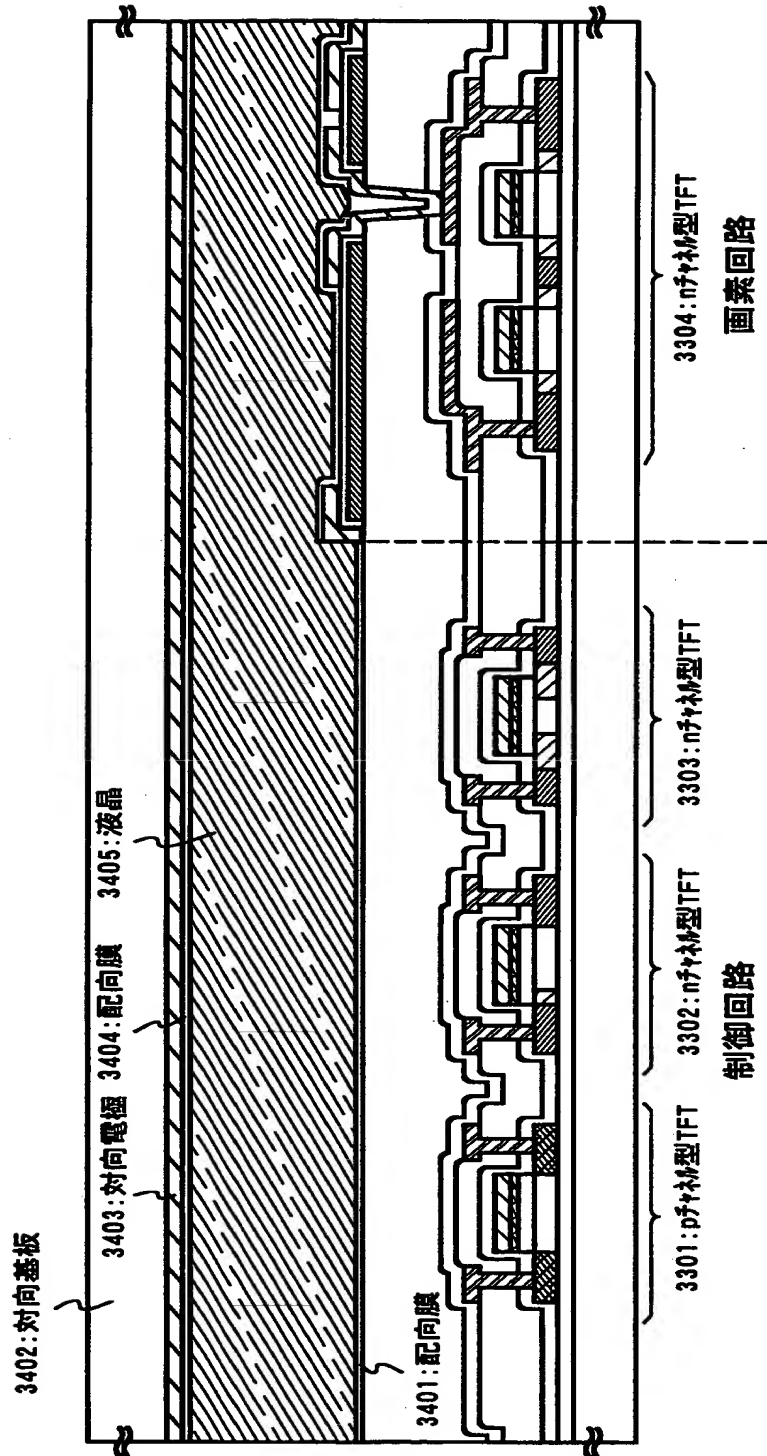
【図 1 6】



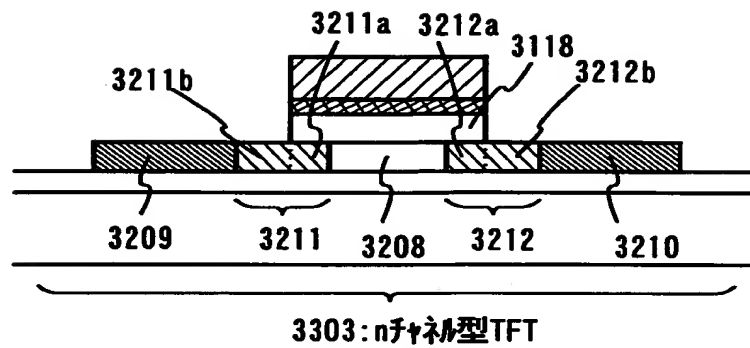
【図 1 7】



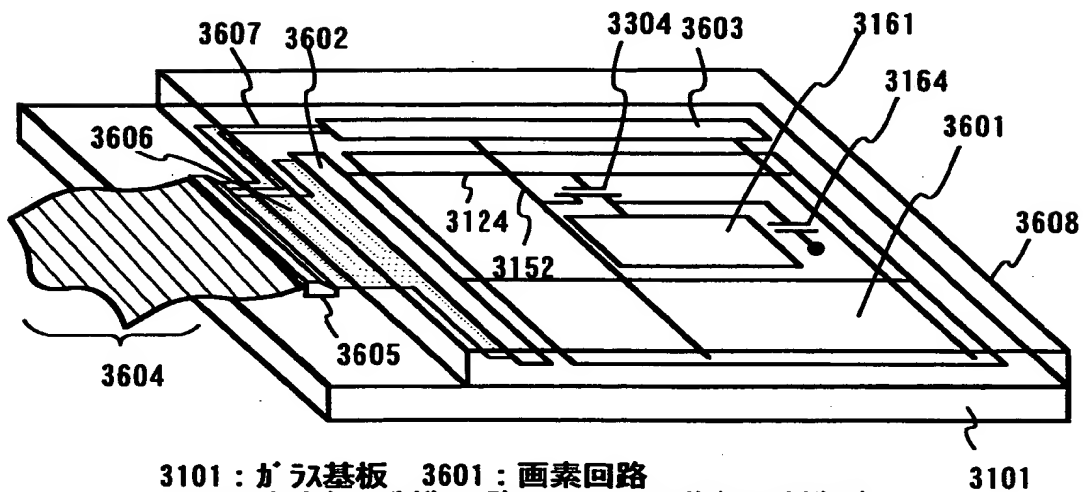
【図 1 8】



【図 1 9】

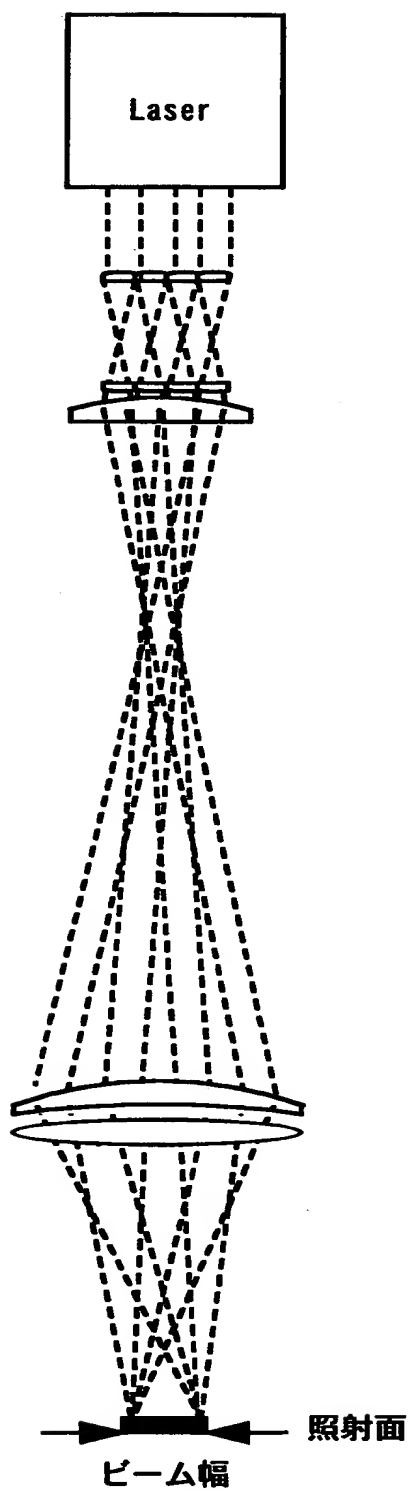


【図 2 0】

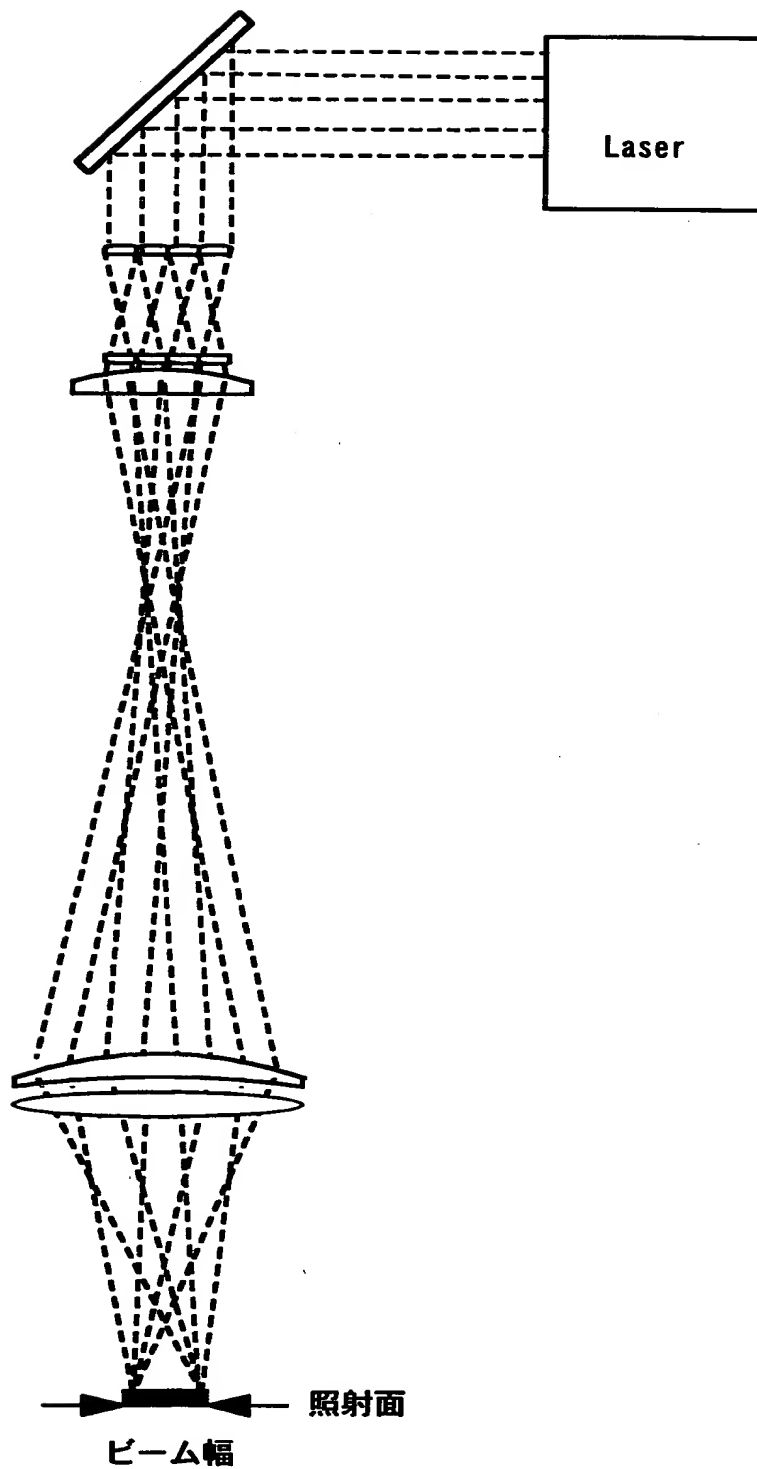


3101: ガラス基板 3601: 画素回路
 3602: 走査信号制御回路 3603: 画像信号制御路
 3604: FPC 3605: 外部入出力端子
 3606, 3607: 接続配線
 3304: 画素TFT 3124: ゲート配線 3152: ソース配線
 3161: 画素電極 3164: 保持容量 3608: 対向基板

【図 2 1】

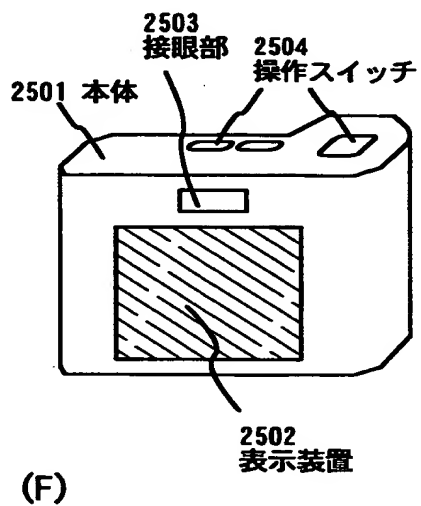
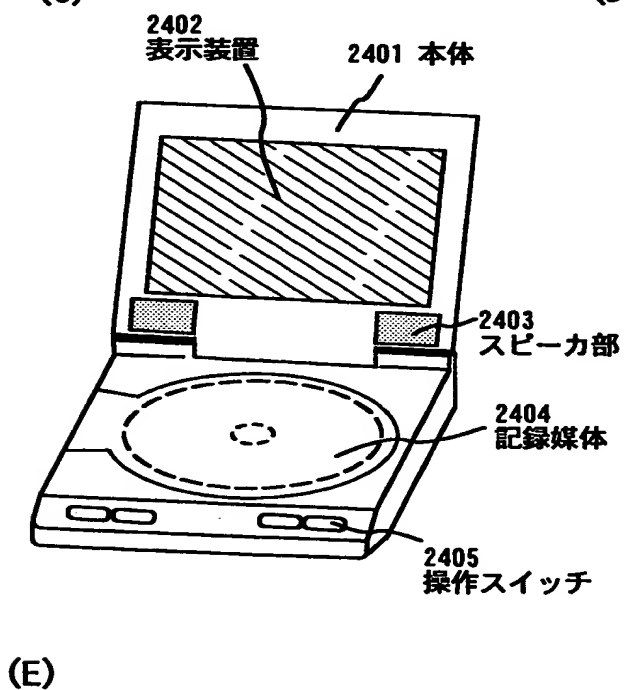
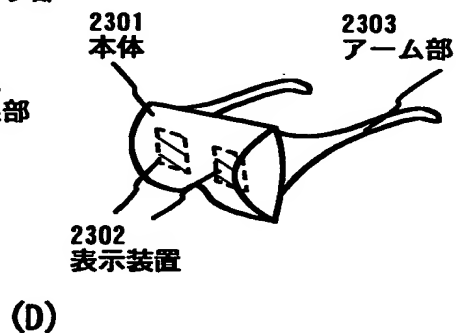
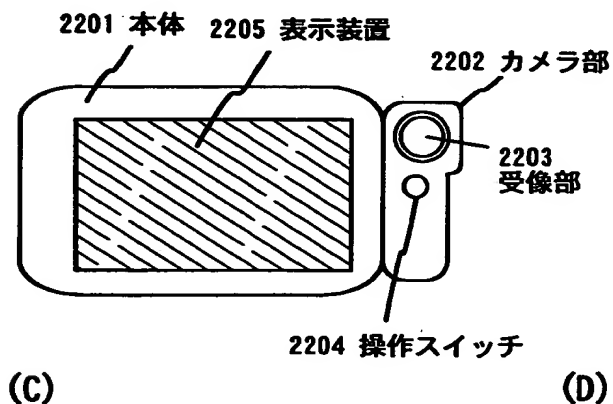
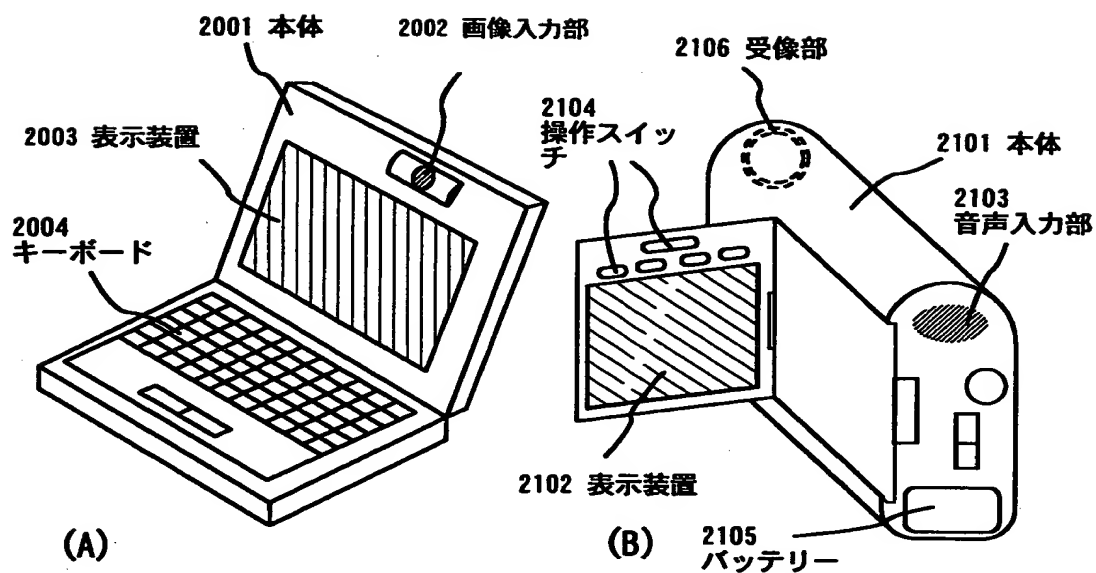


【図 2 2】



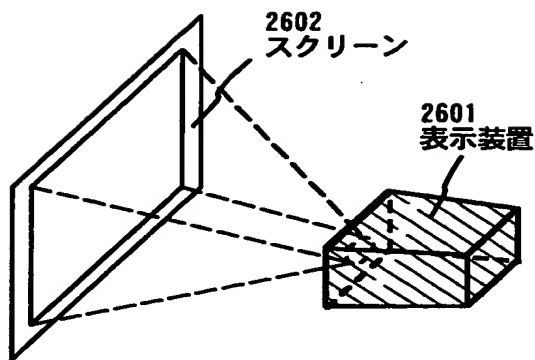
特平 1 1 - 1 4 4 0 6 4

【図 2 3】

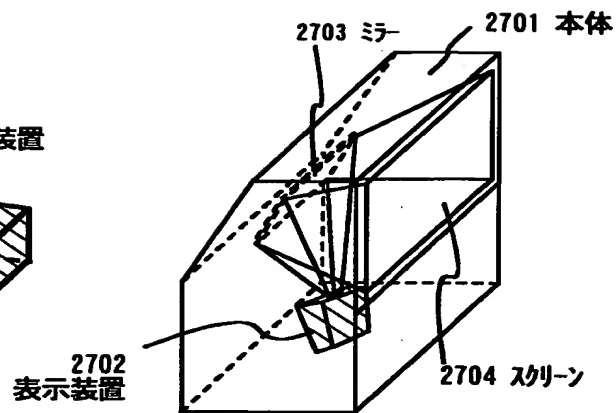


特平 1 1 - 1 4 4 0 6 4

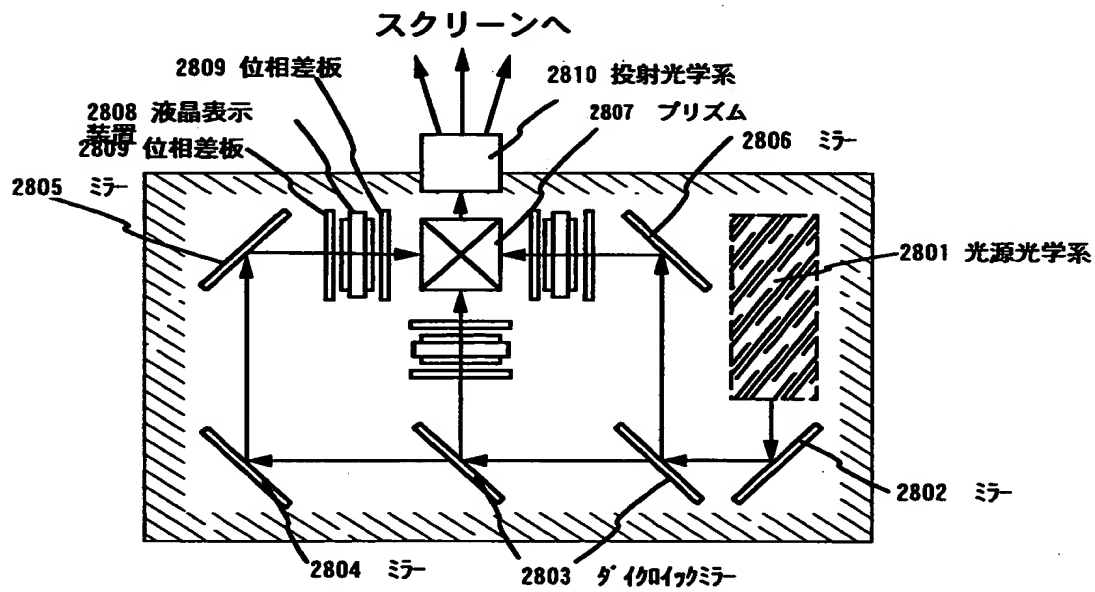
【図 2 4】



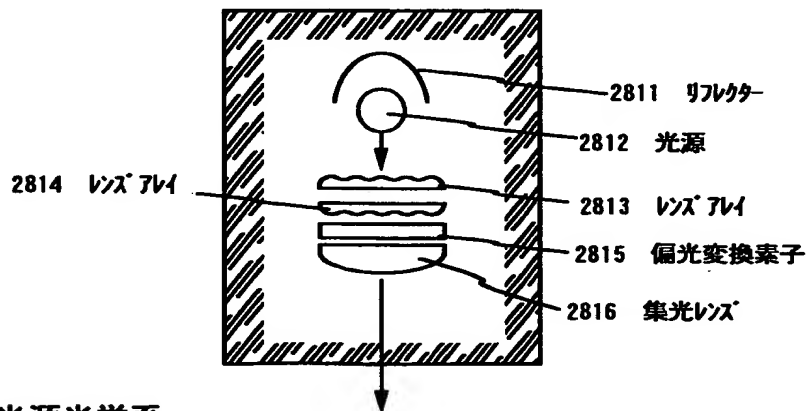
(A)



(B)



(C) 表示装置 (三板式)



(D) 光源光学系

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000153878]

1. 変更年月日	1990年 8月17日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県厚木市長谷398番地
氏 名	株式会社半導体エネルギー研究所